

CF

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開2002-252222

(P2002-252222A)

(43) 公開日 平成14年9月6日 (2002.9.6)

(51) Int.Cl. <sup>7</sup>	識別記号	F I	テームコード(参考)
H 0 1 L 21/312		H 0 1 L 21/312	M 5 F 0 0 4
			C 5 F 0 3 3
21/3065		21/31	C 5 F 0 4 5
21/31		21/302	J 5 F 0 5 8
21/768		21/90	A
審査請求 未請求 請求項の数29 O L (全 30 頁) 最終頁に続く			

(21) 出願番号 特願2001-47358(P2001-47358)

(22) 出願日 平成13年2月22日 (2001.2.22)

(71) 出願人 000004237

日本電気株式会社

東京都港区芝五丁目7番1号

(72) 発明者 大竹 浩人

東京都港区芝五丁目7番1号 日本電気株式会社社内

(72) 発明者 齋藤 忍

東京都港区芝五丁目7番1号 日本電気株式会社社内

(74) 代理人 100102864

弁理士 工藤 実 (外1名)

最終頁に続く

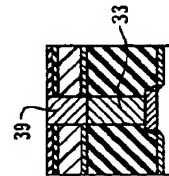
(54) 【発明の名称】 半導体装置の製造方法、及び半導体装置

(57) 【要約】

【課題】 複数の有機膜を高い選択比でエッチングする技術を提供することにある。

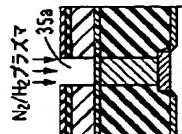
【解決手段】 本発明の半導体装置の製造方法は、シリコン含有有機膜 (34) とシリコン非含有有機膜 (35) から構成される複合膜に対して、窒素と水素との混合系ガスプラズマを用いてシリコン非含有有機膜 (35) をエッチングすることを特徴とする。

(c)

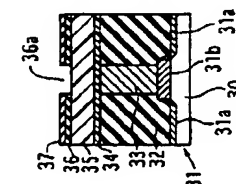


39: 絶縁膜

(b)



(a)



【特許請求の範囲】

【請求項1】 シリコン含有有機膜と有機膜から構成される複合膜に対して、窒素と水素との混合系ガスプラズマを用いて前記有機膜をエッチングすることを特徴とする半導体装置の製造方法。

【請求項2】 シリコン含有有機膜上に形成された有機膜に対し、窒素と水素の混合系ガスプラズマを用いて前記シリコン含有有機膜をエッチングストッパーとして前記有機膜に開口部を形成することを特徴とする請求項1記載の半導体装置の製造方法。

【請求項3】 有機膜上に形成されたシリコン含有有機膜をマスクとし、窒素と水素の混合系ガスプラズマを用いて前記有機膜に開口部を形成することを特徴とする請求項1記載の半導体装置の製造方法。

【請求項4】 第1シリコン含有有機膜の上に有機膜を形成し、前記有機膜の上に第2シリコン含有有機膜を形成し、第2シリコン含有有機膜をマスクとし、且つ、第1のシリコン含有有機膜をエッチングストッパーとして、窒素と水素の混合系ガスプラズマを用いて、前記有機膜に開口を形成することを特徴とする請求項1から請求項3のいずれかに記載の半導体装置の製造方法。

【請求項5】 有機膜上にシリコン含有有機膜と無機絶縁膜とを形成する工程と、  
フォトレジスト有機膜パターンを用いて前記無機絶縁膜を貫き前記シリコン含有有機膜に至る開口部を形成する工程と、

窒素と水素の混合系ガスプラズマを用いてフォトレジスト有機膜パターンを選択的に除去する工程と、  
前記無機絶縁膜に形成された前記開口部をマスクとして前記シリコン含有有機膜および前記有機膜をエッチングする工程を備えることを特徴とする請求項1記載の半導体装置の製造方法。

【請求項6】 シリコン含有絶縁膜と無機絶縁膜とからなる積層膜の表面と、前記積層膜に設けられた開口の内部とに存在する有機膜を、窒素と水素の混合系ガスプラズマを用いて除去することを特徴とする請求項1記載の半導体装置の製造方法。

【請求項7】 前記シリコン含有有機膜がジビニルシロキサンベンゾシクロブテンの重合体で形成されていることを特徴とする請求項1から請求項6のいずれかに記載の半導体装置の製造方法。

【請求項8】 (a)シリコンを含有する有機化合物で形成されたシリコン含有有機膜を形成する工程と、

(b)シリコンを含有しない有機化合物で形成されたシリコン非含有有機膜を、前記シリコン含有有機膜に接続するように形成する工程と、

(c)窒素と水素とを含むエッチングガスを使用して、前記シリコン非含有有機膜をエッチングする工程とを備える半導体装置の製造方法。

【請求項9】 (d)シリコンを含有する第1有機化合

物で形成されたシリコン含有有機膜を、基板の上面側に形成する工程と、

(e) 前記シリコン含有有機膜の上面側に、シリコンを実質的に含有しない第2有機化合物で形成されたシリコン非含有有機膜を形成する工程と、

(f) 前記シリコン非含有有機膜を、窒素と水素とを含むエッチングガスを使用してエッチングし、前記シリコン含有有機膜を露出する工程とを備える半導体装置の製造方法。

10 【請求項10】 請求項9に記載の半導体装置の製造方法において、  
更に、

(g) 前記シリコン非含有有機膜の上面側に、シリコンを含有する有機化合物で形成された他のシリコン含有有機膜を形成する工程と、

(h) 前記他のシリコン含有有機膜に開口を設ける工程とを備え、

前記(f)工程は、

(i)窒素と水素とを含むエッチングガスを使用して、前記シリコン非含有有機膜を前記開口からエッチングし、前記シリコン含有有機膜の表面の一部を露出する工程を含む半導体装置の製造方法。

【請求項11】 請求項10に記載の半導体装置の製造方法において、  
更に、

(j)前記他のシリコン含有有機膜の上面側から、前記シリコン含有有機膜と前記他のシリコン含有有機膜とを同時にエッチングして、前記一部から前記基板に到達する他の開口を形成する工程を備え、

30 前記他のシリコン含有有機膜の膜厚は、前記シリコン含有有機膜の膜厚より厚い半導体装置の製造方法。

【請求項12】 (k)シリコンを実質的に含有しない第1有機化合物で形成されたシリコン非含有有機膜を、基板の上面側に形成する工程と、

(l)前記シリコン非含有有機膜の上面側に、シリコンを含有する第2有機化合物で形成されたシリコン含有有機膜を形成する工程と、

(m)前記シリコン含有有機膜に開口を設ける工程と、

(n)窒素と水素とを含むエッチングガスを使用して、前記シリコン非含有有機膜を前記開口からエッチングし、前記基板を露出する工程とを備える半導体装置の製造方法。

【請求項13】 (o)シリコンを含有する第1有機化合物で形成されたシリコン含有有機膜を形成する工程と、

(p)前記シリコン含有有機膜に開口を形成する工程と、

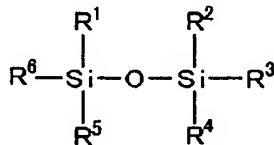
(q)前記開口の内部に、シリコンを含有しない第2有機化合物で形成されたシリコン非含有有機膜を形成する工程と、

(r) 前記シリコン非含有有機膜を窒素と水素とを含むエッチングガスを使用して除去する工程とを備える半導体装置の製造方法。

【請求項 14】 請求項 8 から請求項 13 のいずれかに記載の半導体装置の製造方法において、前記エッチングガスは、実質的に酸素を含まない半導体装置の製造方法。

【請求項 15】 請求項 8 から請求項 13 のいずれかに記載の半導体装置の製造方法において、前記第 1 有機化合物は、下記構造式を有する化合物の重合体を含む半導体装置の製造方法。

【化 1】



R<sup>1</sup> ~ R<sup>6</sup> : 炭化水素基

【請求項 16】 請求項 8 から請求項 13 のいずれかに記載の半導体装置の製造方法において、前記第 1 有機化合物は、ジビニルシロキサンベンゾシクロブテンが重合された重合体を含む半導体装置の製造方法。

【請求項 17】 請求項 8 から請求項 13 のいずれかに記載の半導体装置の製造方法において、前記第 1 有機化合物は、シロキサンポリイミドが重合された重合体を含む半導体装置の製造方法。

【請求項 18】 請求項 8 から請求項 13 のいずれかに記載の半導体装置の製造方法において、前記第 1 有機化合物は、シリコン酸化膜よりも比誘電率が低い半導体装置の製造方法。

【請求項 19】 請求項 8 から請求項 13 のいずれかに記載の半導体装置の製造方法において、前記第 2 有機化合物は、シリコン酸化膜よりも比誘電率が低い半導体装置の製造方法。

【請求項 20】 半導体基板上にシリコンを含まない有機系低誘電率膜と、この有機系低誘電率膜の下もしくは上、あるいはその上下に形成されるシリコン含有有機膜を具備することを特徴とする半導体装置。

【請求項 21】 半導体基板上にシリコンを含まない有機系低誘電率膜と、この有機系低誘電率膜の下もしくは上、あるいはその上下に形成されるシリコン含有有機膜からなる積層膜の開口部に導電膜が選択的に埋め込まれていることを特徴とする請求項 20 記載の半導体装置。

【請求項 22】 シリコン含有有機膜がジビニルシロキサンベンゾシクロブテンが重合された重合体で形成されたことを特徴とする請求項 20 又は請求項 21 のいずれかに記載の半導体装置。

【請求項 23】 シリコンを含む第 1 有機化合物で形成

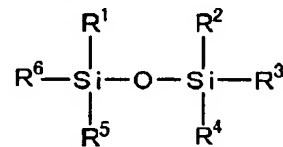
されたシリコン含有有機膜と、

前記シリコン含有有機膜に接続し、且つ、シリコンを含まない第 2 有機化合物で形成されたシリコン非含有有機膜とを備える半導体装置。

【請求項 24】 基板と、前記基板の上面側に形成され、シリコンを含む第 1 有機化合物で形成されたシリコン含有有機膜と、前記シリコン含有有機膜の上面側に形成され、シリコンを含まない第 2 有機化合物で形成され、且つ、前記シリコン含有有機膜に到達する配線溝が形成されたシリコン非含有有機膜と、前記配線溝の内部に形成された導電体とを備える半導体装置。

【請求項 25】 請求項 23 又は請求項 24 のいずれかに記載の半導体装置において、前記第 1 有機化合物は、下記構造式を有する化合物の重合体を含む半導体装置。

【化 2】



【請求項 26】 請求項 23 又は請求項 24 のいずれかに記載の半導体装置において、

前記第 1 有機化合物は、ジビニルシロキサンベンゾシクロブテンが重合された重合体を含む半導体装置。

【請求項 27】 請求項 23 又は請求項 24 のいずれかに記載の半導体装置において、前記第 1 有機化合物は、シロキサンポリイミドが重合された重合体を含む半導体装置。

【請求項 28】 シリコンを含む有機化合物で形成されたシリコン含有有機膜を備えているシリコンを含まない有機化合物で形成された有機膜をエッチングするためのハードマスク。

【請求項 29】 シリコンを含む有機化合物で形成されたシリコン含有有機膜を備えているシリコンを含まない有機化合物で形成された有機膜をエッチングするためのエッチングストッパー膜。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】 本発明は、半導体装置の製造方法に関し、特に、有機膜が含まれる半導体装置の製造方法に関する。

【0002】

【従来の技術】 近年の ULSI デバイスでは、数 mm 角のチップに数百万個以上の半導体素子を集積する必要があり、半導体素子を微細化、多層化することが不可欠である。特にデバイス動作速度の高速化のため、配線抵抗

および層間容量の低減が重要な課題である。

【0003】配線抵抗を低減させるために、銅を配線材料に用いる方法が提案されている。この銅配線は、低抵抗かつ高信頼性であり、次世代配線材料としてもっとも注目されている。しかし、銅は従来のアルミ材料と異なり、ドライエッチングによる加工が難しい。そのため、銅配線の形成には、化学的機械的研磨法(CMP: Chemical Mechanical Polishing)を用いた埋め込み配線技術が行われている。

【0004】図19、図20、及び図21は、典型的な銅の埋め込み配線技術を示す。まず、図19(a)に示されているように、シリコン基板のような半導体ウエハ1aの上面に、MOSトランジスタ1が形成される。即ち、半導体ウエハ1aの上面に、MOSトランジスタ1を構成するソース/ドレイン1b、ゲート1c、及びサイドウォール1dが形成される。

【0005】続いて、図19(b)に示されているように、シリコン酸化膜2のような層間絶縁膜が、MOSトランジスタ1を覆うように形成される。更に、図19(c)に示されているように、MOSトランジスタ1のソース/ドレイン1bに接続するプラグ3が形成される。プラグ3は、タングステンプラグのような導電性プラグで形成される。

【0006】次に、図20(a)に示されているように、シリコン窒化膜4がCVD法により形成される。更に、シリコン窒化膜4の上面に、層間絶縁膜として、シリコン酸化膜5が形成される。シリコン窒化膜4は、シリコン酸化膜5をエッチングする際のエッチングストッパーになる。

【0007】次に、図20(b)に示されているように、シリコン酸化膜5の上面にフォトレジスト6が形成される。フォトレジスト6には、フォトリソグラフィ技術を用いて開口溝6aが形成される。更に、図20(c)に示されているように、フォトレジスト6をマスクとしてシリコン酸化膜5がエッチングされる。更に、酸素プラズマを用いてフォトレジスト6が剥離される。

【0008】更に、図21(a)に示されているように、シリコン酸化膜5をマスクとしてシリコン窒化膜4がエッチングされ、下層とのコンタクト7が形成される。その後、銅がコンタクト7にめっき法によって埋め込まれ、更に化学的機械的研磨法(CMP法)で研磨され、図21(b)に示されているように、銅配線8が形成される。

【0009】他の銅の埋め込み配線技術として、低誘電率有機膜を層間絶縁膜に用いる方法が提案されている(図22、図23、及び図24)。この銅の埋め込み配線技術では、低誘電率有機膜が層間絶縁膜として用いられ、配線間容量の低減が図られている。

【0010】当該埋め込み配線技術では、まず、図22(a)に示されているように、シリコン基板のような半

導体ウエハ1aの上面に、ソース/ドレイン1b、ゲート1c、及びサイドウォール1dが形成される。ソース/ドレイン1b、ゲート1c、及びサイドウォール1dは、MOSトランジスタ1を構成する。続いて、図22(b)に示されているように、MOSトランジスタ1を覆うように、層間絶縁膜としてシリコン酸化膜12が成膜される。

【0011】更に、図22(c)に示されているように、MOSトランジスタ1に接続するプラグ13が形成される。プラグ13は、タングステンプラグのような導電性プラグである。更に、シリコン酸化膜12とプラグ13を被覆するように、シリコン窒化膜14が形成される。さらにシリコン窒化膜14の上面に、層間絶縁膜として、スピン塗布法によって有機膜15が形成される。有機膜15は、ポリアリルスエーテルのような低誘電率有機材料によって形成される。シリコン窒化膜14は、有機膜15をエッチングする際のエッチングストッパーとして機能する。

【0012】さらに、図23(a)に示されているように、積層無機マスク膜としてシリコン窒化膜16とシリコン酸化膜17とが順次に形成される。これにより、低誘電率の有機膜15が高誘電率のシリコン窒化膜14、16に挟まれた構造が形成される。

【0013】次に、図23(b)シリコン酸化膜17の上面にフォトレジスト18が形成され、更に、フォトリソグラフィ技術を用いてフォトレジスト18に開口溝18aが形成される。続いて、図23(c)に示されているように、フォトレジスト18をマスクとしてシリコン酸化膜17がエッチングされ、開口部17aが形成される。更に、酸素プラズマを用いてフォトレジスト18が剥離される。

【0014】前述のシリコン窒化膜16は、フォトレジスト18を剥離する酸素プラズマから、有機膜15を保護するために形成されている。フォトレジスト18を剥離する際、シリコン酸化膜17に形成された開口部17aの底部にはシリコン窒化膜16が存在する。酸素プラズマに有機膜15が曝されてエッチングされることはない。フォトレジスト18の剥離は水素系プラズマによっても可能である。しかし、この水素系プラズマでも有機膜15はエッチングされてしまう。従って、水素系プラズマを使用してフォトレジスト18の剥離を行う場合にも、高誘電率のシリコン窒化膜16が有機膜15の上面に形成される。

【0015】その後、図24(a)に示されているように、バターンニングされたシリコン酸化膜17をハードマスクとして、シリコン窒化膜16がエッチングされる。更に、図24(b)に示されているように、有機膜15が、 $N_2/O_2$ 系プラズマガスを使用してエッチングされる。この際、シリコン窒化膜14がエッチングストッパーとして作用する。

【0016】さらに、エッチングストッパーであるシリコン窒化膜14がエッチングされ、プラグ13に接続するコンタクト孔19aが形成される。その後、図24(c)に示されているように、コンタクト孔19aに、Ta/TaN膜が形成され、銅膜がめっき法により埋め込まれ、更に、CMP法によってコンタクト孔19aの外部のTa/TaN膜及び銅膜が除去されて、有機膜15に埋め込まれた銅配線19が形成される。

【0017】また、銅配線19の形成後に、図25に示されているように、銅配線19およびシリコン酸化膜17を覆うようにキャップ膜20が形成される場合がある。キャップ膜20は、銅配線19に含まれる銅の拡散を抑制すると同時に銅配線19の上部に配線を形成するときに、ストッパー膜の機能を果たす。キャップ膜20はシリコン窒化膜や炭化シリコン膜(SiC)や炭化窒化シリコン膜(SiCN)のような高誘電率無機膜が用いられている。

【0018】このように、公知のその銅の埋め込み配線技術では、ULSIの多層配線の配線間容量を下げることを目的として、層間絶縁膜として低誘電率の有機膜15が導入されている。

【0019】しかし、公知の銅の埋め込み配線技術では、低誘電率の有機膜15が、高誘電率のシリコン窒化膜16で被覆されている。これは、有機膜15は、フォトリソの剥離に用いられる酸素系プラズマや水素系プラズマに対してエッチングされる性質を有しているためである。すなわち、フォトリソ剥離の酸素プラズマエッチング時における有機膜エッチングを避けるために、高誘電率のシリコン窒化膜等の無機絶縁膜で有機膜表面が覆われている。更に、公知の銅の埋め込み配線技術では、有機膜15の下面には、エッチングストッパーとして高誘電率のシリコン窒化膜14が設けられている。

【0020】このように有機膜15が高誘電率のシリコン窒化膜14、16で挟まれていることは、実効的な配線間容量を増大し、好ましくない。

【0021】さらには、公知の銅の埋め込み配線技術では、キャップ膜20にもシリコン窒化膜や炭化シリコン膜(SiC)や炭化窒化シリコン膜(SiCN)等の高誘電率無機膜が用いられる。これは、実効的な配線間容量を増大する点で好ましくない。

【0022】このような問題は、複数の有機膜を高い選択比でエッチングする技術が提供されることにより解決される。複数の有機膜を高い選択比でエッチングする技術が提供されることが望まれる。特に、複数の有機膜を高い選択比でエッチングする技術を使用することにより、配線間容量が削減された半導体装置が製造されることが望まれる。

【0023】また、複数の有機膜を高い選択比でエッチングする技術が提供されれば、半導体装置の製造工程の

自由度が大きくなる。例えば、複数の有機膜を高い選択比でエッチングする技術が提供されれば、半導体装置に含まれるビアの形成と埋め込み配線溝との形成のいずれを先行して行うかによって、半導体装置の製造工程に含まれるエッチング工程や成膜工程を行う順序の自由に選択することができる。

【0024】複数の有機膜を高い選択比でエッチングする技術を使用することにより、半導体装置の製造工程の自由度が高められることが望まれる。

【0025】

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、複数の有機膜を高い選択比でエッチングする技術を提供することにある。

【0026】本発明の他の目的は、複数の有機膜を高い選択比でエッチングする技術を使用して、配線間容量が削減された半導体装置を製造することにある。

【0027】本発明の他の目的は、複数の有機膜を高い選択比でエッチングする技術を使用することにより、半導体装置の製造工程の自由度を高めることにある。

【0028】

【課題を解決するための手段】その課題を解決するための手段は、下記のように表現される。その表現中に現れる技術的事項には、括弧( )つきで、番号、記号等が添記されている。その番号、記号等は、本発明の複数の実施の形態のうちの、少なくとも1つの実施の形態を構成する技術的事項、特に、その実施の形態に対応する図面に表現されている技術的事項に付せられている参照番号、参照記号等に一致している。このような参照番号、参照記号は、請求項記載の技術的事項と実施の形態の技術的事項との対応・橋渡しを明確にしている。このような対応・橋渡しは、請求項記載の技術的事項が実施の形態の技術的事項に限定されて解釈されることを意味しない。

【0029】本発明の半導体装置の製造方法は、シリコン含有有機膜(34、44、46、54、56、62、64、73、82、84、86、103、105)と有機膜(35、45、55、63、72、83、85、109)から構成される複合膜に対して、窒素と水素との混合系ガスプラズマを用いて有機膜(35、45、55、63、72、83、85、109)をエッチングすることを特徴とする。

【0030】有機膜(35、45、55、63、72、83、85、109)は、窒素と水素との混合系ガスプラズマによって、容易にエッチングされるのに対し、シリコン含有有機膜(34、44、46、54、56、62、64、73、82、84、86、103)は、窒素と水素との混合系ガスプラズマによっては、ほとんどエッチングされない。これにより、有機膜(35、45、55、63、72、83、85、109)をエッチングする際に、シリコン含有有機膜(34、44、46、5

4、56、62、64、73、82、84、86、103)に対する選択比を高くすることができる。

【0031】また、当該半導体装置の製造方法は、シリコン含有有機膜(34、44、54、62、82、84)上に形成された有機膜(35、45、55、63、83、85)に対し、窒素と水素の混合系ガスプラズマを用いてシリコン含有有機膜(34、44、54、62、82、84)をエッチングストッパーとして有機膜(35、45、55、63、83、85)に開口部(35a、45a、55a、69b、91a、91b)を形成することを特徴とする。当該半導体装置の製造方法では、窒素と水素の混合系ガスプラズマを用いて有機膜(35、45、55、63、83、85)に開口部(35a、45a、55a、69b、91a、91b)を形成するエッチングは、シリコン含有有機膜(34、44、54、62、82、84)によって停止する。

【0032】また、当該半導体装置の製造方法は、有機膜(45、55、63、85)上に形成されたシリコン含有有機膜(46、56、64、86)をマスクとし、窒素と水素の混合系ガスプラズマを用いて有機膜(45、55、63、85)に開口部(45a、55a、69a、91b)を形成することを特徴とする。当該半導体装置の製造方法では、開口部(45a、55a、69a、91b)を形成するエッチングの際、シリコン含有有機膜(46、56、64、86)は、ほとんどエッチングされず、マスクの役割を果たす。

【0033】また、当該半導体装置の製造方法は、第1シリコン含有有機膜(44、54、62、84)の上に有機膜(45、55、63、85)を形成し、有機膜(45、55、63、85)の上に第2シリコン含有有機膜(46、56、64、86)を形成し、第2シリコン含有有機膜(46、56、64、86)をマスクとし、且つ、第1シリコン含有有機膜(44、54、62、84)をエッチングストッパーとして、窒素と水素の混合系ガスプラズマを用いて、有機膜(45、55、63、85)に開口(45a、55a、69a、91b)を形成することを特徴とする。当該半導体装置の製造方法では、有機膜(45、55、63、85)に開口(45a、55a、69a、91b)を形成するエッチングは、第1シリコン含有有機膜(44、54、62、84)によって停止する。同時に、第2シリコン含有有機膜(46、56、64、86)は、ほとんどエッチングされず、マスクの役割を果たす。

【0034】また、当該半導体装置の製造方法は、有機膜(45、63、85)上にシリコン含有有機膜(46、64、86)と無機絶縁膜(47、65、87)とを形成する工程と、フォトリソスト有機膜パターン(48、66、88)を用いて無機絶縁膜(47、65、87)を貫きシリコン含有有機膜(46、64、86)に至る開口部(47a、65a、87a)を形成する工程

と、窒素と水素の混合系ガスプラズマを用いてフォトリソスト有機膜パターン(48、66、88)を選択的に除去する工程と、無機絶縁膜(47、65、87)に形成された開口部(47a、65a、87a)をマスクとしてシリコン含有有機膜(46、64、86)および有機膜(45、63、85)をエッチングする工程とを備えることを特徴とする。

【0035】また、当該半導体装置の製造方法は、シリコン含有絶縁膜(103、105)と無機絶縁膜(104、106)とからなる積層膜の表面と、積層膜に設けられた開口(103a)の内部とに存在する有機膜(109)を、窒素と水素の混合系ガスプラズマを用いて除去することを特徴とする。当該半導体装置の製造方法は、有機膜(109)を除去する際に、シリコン含有絶縁膜(103、105)はほとんどエッチングされない。したがって、有機膜(109)を除去する際に十分なオーバーエッチングが可能である。

【0036】また、当該半導体装置の製造方法は、シリコン含有有機膜(34、44、46、54、56、62、64、73、82、84、86、103、105)がジビニルシロキサンベンゾシクロブテンの重合体で形成されていることを特徴とする

【0037】本発明による半導体装置の製造方法は、(a)シリコンを含有する有機化合物で形成されたシリコン含有有機膜(34、44、46、54、56、62、64、73、82、84、86、103、105)を形成する工程と、(b)シリコンを含有しない有機化合物で形成されたシリコン非含有有機膜(35、45、55、63、72、83、85、109)を、シリコン含有有機膜(34、44、46、54、56、62、64、73、82、84、86、103、105)に接続するように形成する工程と、(c)窒素と水素を含むエッチングガスを使用して、シリコン非含有有機膜(35、45、55、63、72、83、85、109)をエッチングする工程とを備える。

【0038】シリコン非含有有機膜(35、45、55、63、72、83、85、109)は、窒素と水素との混合系ガスプラズマによって、容易にエッチングされるのに対し、シリコン含有有機膜(34、44、46、54、56、62、64、73、82、84、86、103)は、窒素と水素との混合系ガスプラズマによっては、ほとんどエッチングされない。これにより、シリコン非含有有機膜(35、45、55、63、72、83、85、109)をエッチングする際に、シリコン含有有機膜(34、44、46、54、56、62、64、73、82、84、86、103)に対する選択比を高くすることができる。

【0039】また、当該半導体装置の製造方法は、

(d)シリコンを含有する第1有機化合物で形成されたシリコン含有有機膜(34、44、54、62、82、

84)を、基板(30~33、40~43、50~53、61、71、82、101)の上面側に形成する工程と、(e) シリコン含有有機膜(34、44、54、62、82、84)の上面側に、シリコンを実質的に含有しない第2有機化合物で形成されたシリコン非含有有機膜(35、45、55、63、83、85)を形成する工程と、(f) シリコン非含有有機膜(35、45、55、63、83、85)を、窒素と水素とを含むエッチングガスを使用してエッチングし、シリコン含有有機膜(34、44、54、62、82、84)を露出する工程とを備える。当該半導体装置の製造方法は、シリコン非含有有機膜(35、45、55、63、83、85)のエッチングが、シリコン含有有機膜(34、44、54、62、82、84)の上面で停止する。

【0040】当該半導体装置の製造方法は、更に、(g) シリコン非含有有機膜(45、55、63、85)の上面側に、シリコンを含有する有機化合物で形成された他のシリコン含有有機膜(46、56、64、86)を形成する工程と、(h) 他のシリコン含有有機膜(46、56、64、86)に開口を設ける工程とを備え、前述の(f)工程は、(i) 窒素と水素とを含むエッチングガスを使用して、シリコン非含有有機膜(45、55、63、85)をその開口からエッチングし、シリコン含有有機膜(44、54、62、82、84)の表面の一部を露出する工程を含むことがある。当該半導体装置の製造方法では、シリコン非含有有機膜(45、55、63、85)のエッチングは、シリコン含有有機膜(44、54、62、82、84)によって停止する。同時に、他のシリコン含有有機膜(46、56、64、86)は、ほとんどエッチングされず、マスクの役割を果たす。

【0041】このとき、当該半導体装置の製造方法は、更に、(j) 他のシリコン含有有機膜(56)の上面側から、シリコン含有有機膜(54)と他のシリコン含有有機膜(56)とを同時にエッチングして、シリコン含有有機膜(54)の表面の露出された部分から基板(50~53)に到達する他の開口を形成する工程を備えることがある。このとき、他のシリコン含有有機膜(56)の膜厚は、シリコン含有有機膜(54)の膜厚より厚いことが好ましい。

【0042】本発明の半導体装置の製造方法は、(k) シリコンを実質的に含有しない第1有機化合物で形成されたシリコン非含有有機膜(45、55、63、85)を、基板(40~44、50~54、61、62、81~84)の上面側に形成する工程と、(l) シリコン非含有有機膜(45、55、63、85)の上面側に、シリコンを含有する第2有機化合物で形成されたシリコン含有有機膜(46、56、64、86)を形成する工程と、(m) シリコン含有有機膜(46、56、64、8

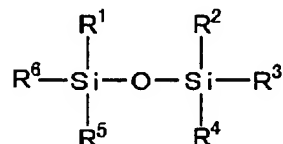
6)に開口を設ける工程と、(n) 窒素と水素とを含むエッチングガスを使用して、シリコン非含有有機膜(45、55、63、85)をその開口からエッチングし、基板(40~44、50~54、61、62、81~84)を露出する工程とを備えている。

【0043】また、本発明による半導体装置の製造方法は、(o) シリコンを含有する第1有機化合物で形成されたシリコン含有有機膜(103、105)を形成する工程と、(p) シリコン含有有機膜(103、105)に開口(103a)を形成する工程と、(q) 開口(103a)の内部に、シリコンを含有しない第2有機化合物で形成されたシリコン非含有有機膜(109)を形成する工程と、(r) シリコン非含有有機膜(109)を窒素と水素とを含むエッチングガスを使用して除去する工程とを備えている。当該半導体装置の製造方法は、シリコン非含有有機膜(109)を除去する際に、シリコン含有絶縁膜(103、105)はほとんどエッチングされない。したがって、有機膜(109)を除去する際に充分なオーバーエッチングが可能である。

【0044】当該半導体装置の製造方法において、窒素と水素とを含むエッチングガスは、実質的に酸素を含まないことが望ましい。窒素と水素とを含むエッチングガスに、酸素が含まれていると、シリコン含有有機膜(34、44、46、54、56、62、64、73、82、84、86、103、105)がエッチングされてしまい好ましくない。

【0045】また、当該半導体装置の製造方法において、第1有機化合物は、下記構造式を有する化合物の重合体を含むことが好ましい。

【化3】



【0046】また、当該半導体装置の製造方法において、第1有機化合物は、ジビニルシロキサンベンゾシクロブテンが重合された重合体を含むことが好ましい。

【0047】また、当該半導体装置の製造方法において、第1有機化合物は、シロキサンポリイミドが重合された重合体を含むことが好ましい。

【0048】また、当該半導体装置の製造方法において、第1有機化合物は、シリコン酸化膜よりも比誘電率が低いことが好ましい。

【0049】また、当該半導体装置の製造方法において、第2有機化合物は、シリコン酸化膜よりも比誘電率が低いことが好ましい。

【0050】本発明による半導体装置の構造は、半導体基板(30、40、50)上にシリコンを含まない有機



13

系低誘電率膜（35、45、55、63、72、83、85、109）と、この有機系低誘電率膜（35、45、55、63、72、83、85、109）の下もしくは上、あるいはその上下に形成されるシリコン含有有機膜（34、44、46、54、56、62、64、73、82、84、86、103、105）を具備することを特徴とする。

【0051】また、本発明による半導体装置の構造は、半導体基板上にシリコンを含まない有機系低誘電率膜と、この有機系低誘電率膜の下もしくは上、あるいはその上下に形成されるシリコン含有有機膜からなる積層膜の開口部に導電膜が選択的に埋め込まれていることを特徴とする。

【0052】また、本発明による半導体装置の構造は、シリコン含有有機膜（34、44、46、54、56、62、64、73、82、84、86、103、105）がジビニルシロキサンベンゾシクロブテンが重合された重合体で形成されたことを特徴とする。

【0053】本発明による半導体装置は、シリコンを含む第1有機化合物で形成されたシリコン含有有機膜（34、44、46、54、56、62、64、73、82、84、86、103、105）と、シリコン含有有機膜（34、44、46、54、56、62、64、73、82、84、86、103、105）に接続し、且つ、シリコンを含まない第2有機化合物で形成されたシリコン非含有有機膜（35、45、55、63、72、83、85、109）とを備えている。当該半導体装置は、窒素と水素との混合系ガスプラズマによって、シリコン非含有有機膜（35、45、55、63、72、83、85、109）をエッチングすることにより、され

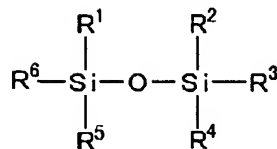
たシリコン含有有機膜（34、44、46、54、56、62、64、73、82、84、86、103、105）と、シリコン含有有機膜（34、44、46、54、56、62、64、73、82、84、86、103、105）との選択比を高くしながら製造され得る。

【0054】また、本発明による半導体装置は、基板（61、81～83）と、基板（61、81～83）の上面側に形成され、シリコンを含む第1有機化合物で形成されたシリコン含有有機膜（62、84）と、シリコン含有有機膜（62、84）の上面側に形成され、シリコンを含まない第2有機化合物で形成され、且つ、シリコン含有有機膜（62、84）に到達する配線溝（69b、91）が形成されたシリコン非含有有機膜（63、85）と、配線溝（69b、91）の内部に形成された導電体（70、92）とを備える。

【0055】また、当該半導体装置において、第1有機化合物は、下記構造式を有する化合物の重合体を含むことが好ましい。

【化4】

14



【0056】本発明によるハードマスクは、シリコンを含まない有機化合物で形成された有機膜（45、55、63、85）をエッチングするためのハードマスクである。当該ハードマスクは、シリコンを含む有機化合物で形成されたシリコン含有有機膜（46、56、64、86）を備えている。

【0057】本発明によるエッチングストッパー膜は、シリコンを含まない有機化合物で形成された有機膜（35、45、55、63、83、85）をエッチングするためのエッチングストッパー膜である。当該シリコンを含む有機化合物で形成されたシリコン含有有機膜（32、44、54、62、82、84）を備えている。

【0058】

【発明の実施の形態】以下、添付図面を参照しながら、本発明による実施の一形態の半導体集積回路の製造方法を説明する。

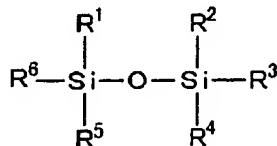
【0059】本発明による実施の一形態の半導体集積回路の製造方法では、シリコンを含有する有機化合物で形成されたシリコン含有有機膜と、シリコンを含有しない有機化合物で形成されたシリコン非含有有機膜とが積層され、積層構造体が形成される。

【0060】更に、シリコン非含有有機膜が、窒素ガスと水素ガスとを含むエッチングガス中で発生された $\text{N}_2/\text{H}_2$ プラズマによりエッチングされる。シリコン非含有有機膜が、 $\text{N}_2/\text{H}_2$ プラズマにより容易にエッチングされるのに対し、シリコン含有有機膜は、 $\text{N}_2/\text{H}_2$ プラズマに対して耐エッチングを有する。即ち、シリコン含有有機膜とシリコン非含有有機膜とが積層された積層構造体を $\text{N}_2/\text{H}_2$ プラズマによりエッチングすると高い選択比が得られる。

【0061】また、シリコン含有有機膜を構成する有機化合物としては、シロキサン結合（ $\text{Si}-\text{O}-\text{Si}$ ）を持つ有機化合物が重合された重合体が好ましい。特に、

下記構造式：

【化5】



を有する有機化合物が重合された重合体が使用されることが好ましい。ここで、 $\text{R}^1 \sim \text{R}^6$ は、いずれも、炭化水素である。



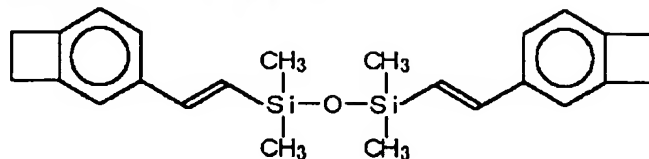
15

【0062】このとき、〔化5〕で示される有機化合物が重合された重合体としては、特に、ジビニルシロキサンベンゾシクロブテンが重合されたジビニルシロキサンベンゾシクロブテン重合体を使用されることが好まし \*

16

\*い。ジビニルシロキサンベンゾシクロブテンは、次式の構造を有する。

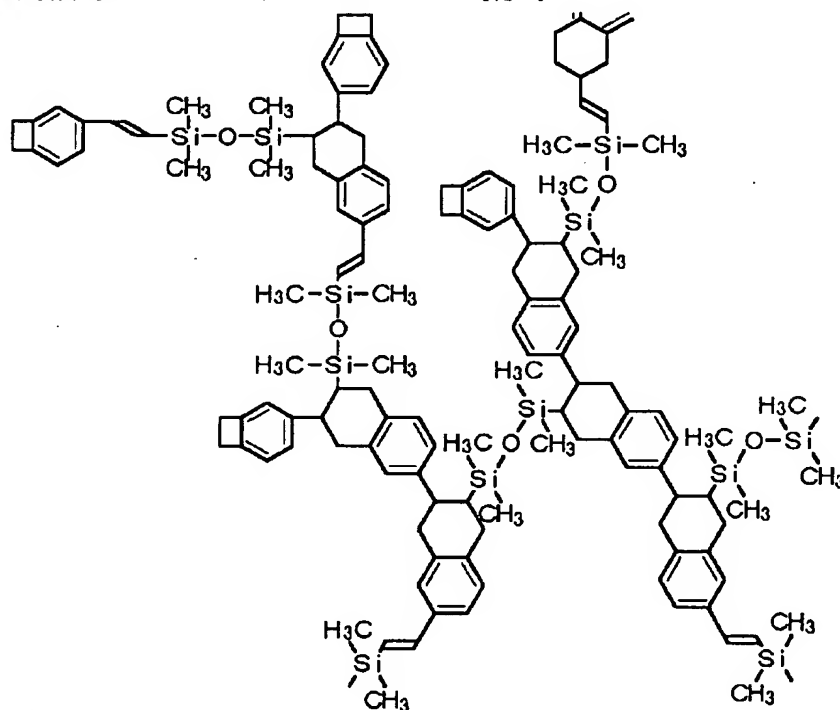
〔化6〕



ジビニルシロキサンベンゾシクロブテンが重合されると、次式の構造を有するジビニルシロキサンベンゾシクロブテン重合体※

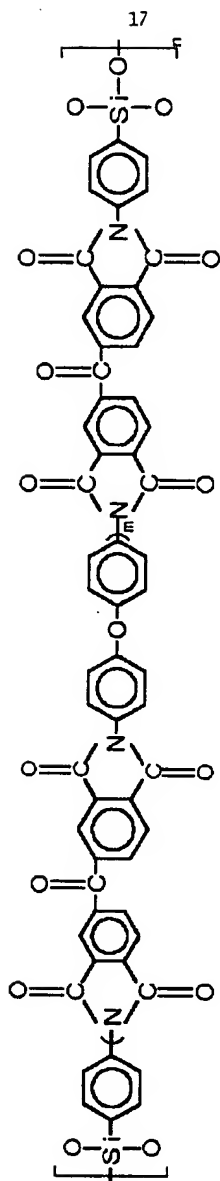
※ロブテン重合体が形成される。

〔化7〕



【0063】また、シロキサンポリイミドが重合されたシロキサンポリイミド重合体を使用することも好ましい。シロキサンポリイミド重合体は、次式の構造を有する。

〔化8〕



【0064】シリコン含有有機膜は、スピン塗付法及びプラズマ重合法のいずれの成膜方法で形成することも可能である。スピン塗付法が使用される場合、まず、出発原料であるモノマーが基板にスピン塗付される。更に、基板をアニールすることにより、モノマーが熱重合され、シリコン含有有機膜が形成される。また、プラズマ重合法が使用される場合、出発原料であるモノマーが気化されて、モノマー蒸気が生成される。そのモノマー蒸気が不活性ガス中に導入され、更に重合されて、シリコン含有有機膜が形成される。

【0065】一方、前述のシリコン非含有有機膜は、  
(1) 半導体装置を構成する層間絶縁膜

18

(2) フォトリソスト

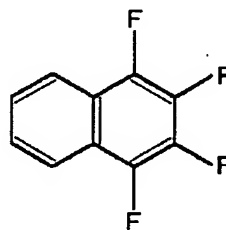
(3) フォトリソグラフィーを行う際の反射防止膜の3つの使用形態で使用され得る。

【0066】シリコン非含有有機膜が半導体装置を構成する層間絶縁膜として使用される場合、シリコン非含有有機膜の比誘電率は、シリコン酸化膜よりも低いことが好ましい。このようなシリコン非含有有機膜としては、全芳香族有機化合物で構成されているSilk™（米国ダウケミカル社製の化学物質の商品名）が使用され得る。また、シリコン非含有有機膜としては、フッ化ナフタレン、ナフタレン、マレイミドベンゾシクロブテン、パーフロシクロブテンアロマティックエーテル（PFCB）、及びフッ化ベンゾシクロブテンの重合体が使用され得る。

【0067】フッ化ナフタレン、ナフタレン、マレイミドベンゾシクロブテン、パーフロシクロブテンアロマティックエーテル（PFCB）、フッ化ベンゾシクロブテンの構造式を以下に示す。フッ化ナフタレン：

【化9】

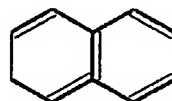
20



ナフタレン：

【化10】

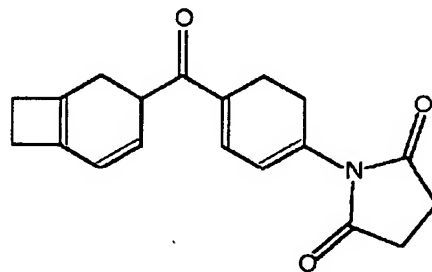
30



マレイミドベンゾシクロブテン：

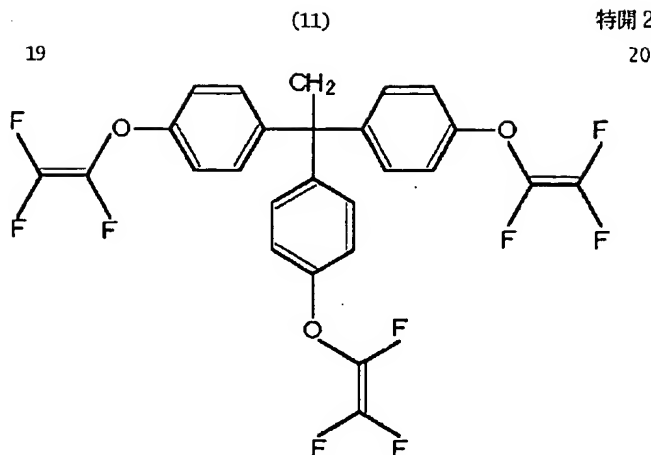
【化11】

40



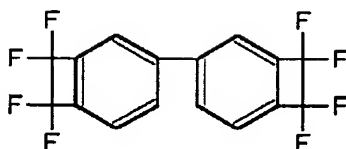
パーフロシクロブテンアロマティックエーテル（PFCB）：

【化12】



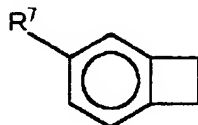
フッ化ベンゾシクロブテン:

【化13】



【0068】また、半導体装置を構成する層間絶縁膜として使用されるシリコン非含有有機膜は、下記構造式で示されるベンゾシクロブテンの誘導体が重合された重合体で形成されることが可能である。

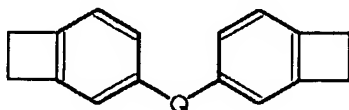
【化14】



ここでR<sup>7</sup>は、ビニル基のような不飽和炭化水素基である。シリコン非含有有機膜が、【化14】で示されるベンゾシクロブテンの誘導体が重合された重合体で形成されることは、ベンゾシクロブテンの誘導体のモノマーから、重合体が形成される際に副生成物が生成されない点で好ましい。

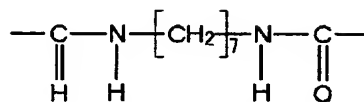
【0069】また、半導体装置を構成する層間絶縁膜として使用されるシリコン非含有有機膜は、下記構造式で示されるベンゾシクロブテン誘導体の重合体で形成された有機膜であることが可能である。

【化15】

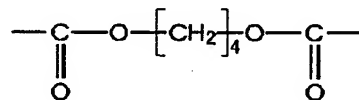


但し、Qは、以下に示される構造式群のいずれかの構造式を有する基である。

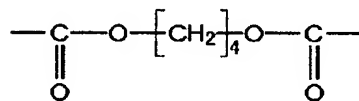
【化16】



【化17】



【化18】



【化19】



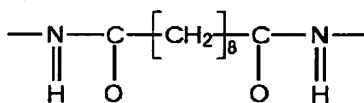
【化20】



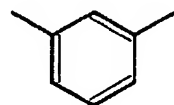
【化21】



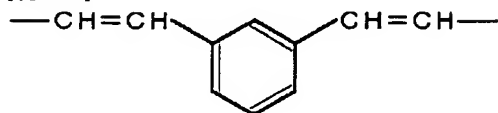
【化22】



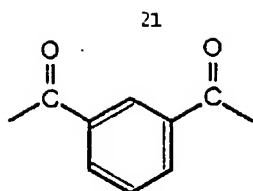
【化23】



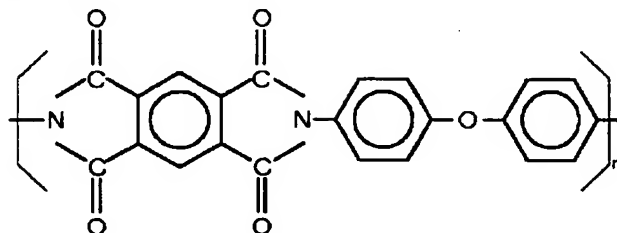
【化24】



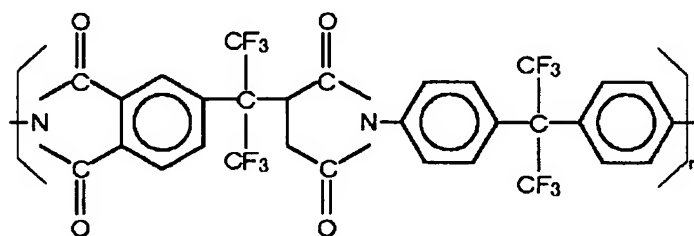
【化25】



【0070】シリコン非含有有機膜が、【化15】～【化25】で示されるベンゾシクロブテンの誘導体が重合された重合体で形成されることは、ベンゾシクロブテ\*

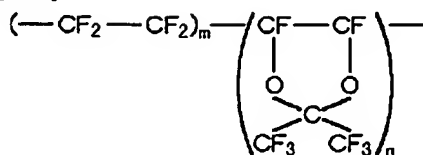


【化27】

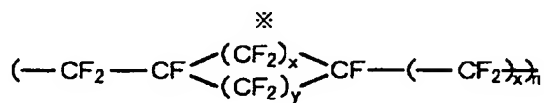


フッ素樹脂：

【化28】



※【化29】



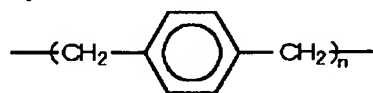
バリレン：

【化30】

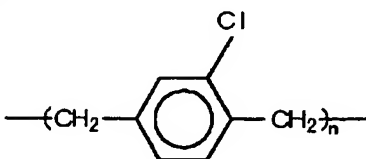


【化32】

40

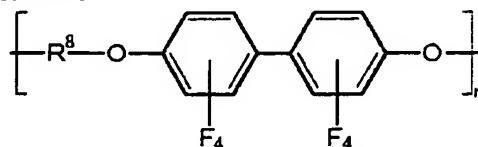


【化31】



ポリアリルエーテル及びそのフッ素化誘導体：

【化33】



【0072】以下では、シリコン含有有機膜として、ジビニルシロキサンベンゾシクロブテン重合体で形成された有機膜（以下、単に、「BCB膜」という）が使用され、シリコン非含有有機膜として、Silk<sup>TM</sup>（米国ダウケミカル社製）で形成されたSilk<sup>TM</sup>膜が使用される場合の、シリコン含有有機膜とシリコン非含有有機膜の形成方法、エッチング方法及びエッチング特性を示す。

【0073】BCB膜は、プラズマ重合法により形成される。図18は、BCB膜を形成するプラズマ重合装置200を示す。プラズマ重合装置200は、原料タンク201、液体流量制御器202、気化器203、気体流量制御器204、真空反応室205、ポンプ206、及びRF電源207を含む。

【0074】原料タンク201は、ジビニルシロキサンベンゾシクロブテンモノマー211を気化器203に供給する。原料タンク201には、ジビニルシロキサンベンゾシクロブテンモノマー211が入っている。ジビニルシロキサンベンゾシクロブテンモノマー211は、室温で液体である。原料タンク201には、加圧Heガス212が供給されている。ジビニルシロキサンベンゾシクロブテンモノマー211は、加圧Heガス212により加圧され、液体流量制御器202を介して気化器203に送られる。

【0075】気化器203は、ジビニルシロキサンベンゾシクロブテンモノマー211を気化して気化モノマー214を生成し、真空反応室205に供給する。気化器203には、気体流量制御器204を介して、Heキャリアガス213が供給されている。ジビニルシロキサンベンゾシクロブテンモノマー211とHeキャリアガス213とは混合され、気化器203に含まれる気化室（図示されない）に送られる。気化室は、1.3×10<sup>-1</sup>Pa程度に減圧され、更に、200℃程度に加熱されている。気化室に送られたジビニルシロキサンベンゾシクロブテンモノマー211は、瞬時に気化され、気化モノマー214が生成される。ジビニルシロキサンベンゾシクロブテンモノマー211の気化能は、0.1～0.5g/min程度である。気化された気化モノマー214は、真空反応室215に送られる。

【0076】真空反応室205では、気化モノマー214\*40

\*4が重合され、BCB膜216が基板215に形成される。真空反応室205は、ポンプ206によって減圧される。真空反応室205には、基板ヒータ205aとシャワーヘッド205bとが設けられている。基板ヒータ205aには、低周波電源（図示されない）が接続され、430kHzの低周波電圧が供給される。シャワーヘッド205bには、RF電源207が接続され、13.56MHzの高周波電圧が供給される。基板ヒータ205aに430kHzの低周波電圧が、シャワーヘッド205bに13.56MHzの高周波電圧が供給されると、基板ヒータ205aとシャワーヘッド205bとの間に、Heプラズマ217が発生する。Heプラズマ217の中に、気化モノマー214が導入されると、

【化6】の構造式を持つジビニルシロキサンベンゾシクロブテンが有するシクロ基の開環反応とビニル基の重合反応とが進行し、【化7】の構造式を持つジビニルシロキサンベンゾシクロブテン重合体からなるBCB膜216が基板215に形成される。このような成膜方法により、耐熱性が400℃以上、比誘電率kが2.4～2.7であるBCB膜216が、実際に得られる。

【0077】一方、シリコン非含有有機膜を構成するSilk<sup>TM</sup>は、全芳香族有機化合物であり、炭素と水素から構成されている。Silk<sup>TM</sup>のポリマーで形成されるSilk<sup>TM</sup>膜は、以下の過程で形成される。まず、Silk<sup>TM</sup>のモノマー溶液を基板に塗付する。続いて、モノマー溶液が塗布された基板を、窒素中で100℃～150℃程度でアニールし、モノマー溶液に含まれている溶媒を乾燥する。続いて、基板を、400℃で30分程度加熱する。加熱により熱重合反応が発生し、Silk<sup>TM</sup>のポリマーからなるSilk<sup>TM</sup>膜が形成される。Silk<sup>TM</sup>膜の耐熱性は450℃、比誘電率k=2.6である。

【0078】下記の【表1】は、上述の工程により形成されたBCB膜とSilk<sup>TM</sup>膜とを、それぞれエッチングしたときのエッチング速度を示す。エッチング速度は、（1）N<sub>2</sub>ガスとH<sub>2</sub>ガスの混合ガスをエッチングガスにしてエッチングした場合と、（2）N<sub>2</sub>ガスとO<sub>2</sub>ガスの混合ガスをエッチングガスにしてエッチングした場合とについて示されている。

【表1】

	N <sub>2</sub> +H <sub>2</sub> ガス	N <sub>2</sub> +O <sub>2</sub> ガス
Silk <sup>TM</sup> 膜	350nm/min	1400nm/min
BCB膜	0nm/min	120nm/min

但し、エッチング条件は、以下の通りである。N<sub>2</sub>ガスとH<sub>2</sub>ガスの混合ガスをエッチングガスとして使用したときのN<sub>2</sub>ガスの流量とH<sub>2</sub>ガスの流量とは、いずれも200sccmである。即ち、N<sub>2</sub>ガスとH<sub>2</sub>ガスの混

合ガスの組成比は、[N<sub>2</sub>]:[H<sub>2</sub>]=1:1である。また、N<sub>2</sub>ガスとO<sub>2</sub>ガスの混合ガスをエッチングガスとして使用したときのN<sub>2</sub>ガスの流量は、150sccmであり、O<sub>2</sub>ガスの流量は、30sccmであ

る。即ち、 $N_2$  ガスと $O_2$  ガスの混合ガスの組成比は、 $[N_2] : [O_2] = 5 : 1$ である。また、使用されているエッチング装置は、平行平板電極型のエッチング装置であり、電極間距離は、30 (mm)である。また、上部電極への供給電力は、1800 (W)、下部電極への供給電力は、150 (W)、エッチング圧力は、2.7 (Pa)である。

【0079】[表1]に示されているように、シリコン非含有有機膜であるSilk<sup>TM</sup>膜は、 $N_2$  ガスと $H_2$  ガスの混合ガスをエッチングガスとしてエッチングすると、エッチングが進行する。一方、シリコン含有有機膜であるBCB膜は、 $N_2$  ガスと $H_2$  ガスの混合ガスをエッチングガスとしてエッチングしようとしても、エッチングがほとんど進行しない。このように、BCB膜は、 $N_2$  ガスと $H_2$  ガスの混合ガス中で発生されたプラズマに対して耐エッチング性を有する。これは、有機高分子中に存在するシリコンが水素プラズマに対して不活性であることに起因すると推定される。

【0080】一方、BCB膜は、 $N_2$  ガスと $O_2$  ガスの混合ガスをエッチングガスとしてエッチングすると、エッチングされる。これは、BCB膜は、 $N_2$  ガスと $O_2$  ガスとの混合ガス中で発生された $N_2/O_2$  プラズマにより、エッチング可能であることを示している。

【0081】シロキサンポリイミド重合膜のような、他のシリコン含有有機膜についても、同様なエッチング特性が認められる。

【0082】シリコン非含有有機膜をエッチングする際のエッチングガスは、 $N_2$  ガスが含まれず、 $H_2$  ガスが100%であることも可能である。しかし、エッチングガスが、 $N_2$  ガスと $H_2$  ガスの混合ガスであることにより、エッチング速度は増加する。したがって、シリコン非含有有機膜をエッチングする際のエッチングガスとしては、 $N_2$  ガスと $O_2$  ガスの混合ガスが使用されることが好ましい。好ましくは、 $N_2$  ガスと $H_2$  ガスのモル比は、 $[N_2] : [H_2] = 1 : 3$ であることが好ましい。これにより、エッチングガスが $H_2$  ガスが100%である場合の約2倍のエッチング速度が得られる。

【0083】シリコン含有有機膜をエッチングする際には、エッチングガスである $N_2$  ガスと $O_2$  ガスの混合ガスにフルオロカーボンのようなフッ素系ガスを添加することが望ましい。シリコンのフッ化物の蒸気圧は低いため、シリコン含有有機膜をエッチングしたときに残渣が残りにくくなる。このとき、全エッチングガスに対するフッ素系ガスのモル比は、0.1~5.0 mol%であることが望ましい。

【0084】シリコン含有有機膜のシリコン含有率は、比誘電率とエッチング特性の観点から、45質量%以下であることが望ましく、特に、20質量%以下であることが望ましい。シリコン含有率が50質量%を超えると、比誘電率が顕著に増大する。更に、シリコン含有率

が50質量%を超えると、 $N_2$  ガスと $O_2$  ガスの混合ガスをエッチングガスとしてエッチングする際、エッチングしにくくなる。

【0085】また、シリコン含有有機膜のシリコン含有率は、 $N_2/H_2$  プラズマに対する耐エッチング性の観点から、1質量%以上であることが望ましい。

【0086】以上に説明されているように、本実施の形態の半導体装置の製造方法は、シリコンを含有する有機化合物で形成されたシリコン含有有機膜とシリコンを含有しない有機化合物で形成されたシリコン非含有有機膜とを積層する工程と、 $N_2$  ガスと $H_2$  ガスの混合ガスをエッチングガスとしてシリコン非含有有機膜をエッチングする工程とを含む。このような半導体装置の製造方法は、以下の使用形態で使用され得る。

(1)シリコン含有有機膜をマスクとして、シリコン非含有有機膜をエッチングするエッチング加工。

(2)シリコン含有有機膜をエッチングストッパーとしてシリコン非含有有機膜に開口を形成する開口形成。

(3)シリコン非含有有機膜であるフォトリソストや反射防止膜を、シリコン含有有機膜の上から、又はシリコン含有有機膜に形成された開口から選択的に除去する選択除去。

以下では、(1)~(3)の使用形態が、実施例により詳細に説明される。

【0087】

【実施例】実施例1：図1、図2及び図3は、実施例1に係る半導体装置の製造方法を示す断面図である。実施例1では、シリコン含有有機膜をエッチングストッパーとしてシリコン非含有有機膜に開口が形成される。

【0088】まず、図1(a)に示されているように、シリコン基板30の上面に、MOSトランジスタ31が形成される。より詳細には、シリコン基板30の上面に、ソース/ドレイン31a、ゲート31b、及びサイドウォール31cが形成される。ソース/ドレイン31b、ゲート31c、及びサイドウォール31dは、MOSトランジスタ31を構成する。

【0089】続いて、図1(b)に示されているように、シリコン酸化膜32が、層間絶縁膜として、MOSトランジスタ31を覆うように形成される。更に、図1(c)に示されているように、MOSトランジスタ31のソース/ドレイン31bに接続するプラグ33が形成される。プラグ33は、タングステンプラグのような導電性プラグで形成される。

【0090】続いて、図2(a)に示されているように、シリコン酸化膜32とプラグ33とを被覆するように、BCB膜34が形成される。前述されているように、BCB膜34は、ジビニルシロキサンベンゾシクロブテン重合体により構成されるシリコン含有有機膜である。BCB膜34は、シリコン酸化膜よりも低い比誘電率を有し、その比誘電率は2.6である。

【0091】更に、BCB膜34の上面に、Silk<sup>T</sup>膜35が形成される。Silk<sup>T</sup>膜35は、スピ  
ンオン塗付により形成される。後述されるように、Si  
lk<sup>T</sup>膜35の下面にあるBCB膜34は、Silk<sup>T</sup>  
膜35をエッチングする際のエッチングストッパー  
になる。

【0092】更に、Silk<sup>T</sup>膜35の上面に、シリ  
コン窒化膜36とシリコン酸化膜37とが順次に形成さ  
れる。シリコン窒化膜36とシリコン酸化膜37とは、  
Silk<sup>T</sup>膜35をエッチングする際のハードマスク 10  
になる。

【0093】続いて、図2(b)に示されているよう  
に、シリコン酸化膜37の上面に、フォトレジスト38  
が形成される。更に、フォトリソグラフィ技術によ  
り、フォトレジスト38にレジストパターン38aが形  
成される。

【0094】続いて、図2(c)に示されているよう  
に、レジストパターン38aが形成されたフォトレジ  
スト38をマスクとして、シリコン酸化膜37がエッチ  
ングされ、開口37aが形成される。更に、酸素プラズマ 20  
により、フォトレジスト38が除去される。このとき、  
Silk<sup>T</sup>膜35の上面は、シリコン窒化膜36により  
被覆され、Silk<sup>T</sup>膜35は酸素プラズマに曝され  
ない。したがって、フォトレジスト38を除去する際  
に、Silk<sup>T</sup>膜35がエッチングされることはな  
い。

【0095】続いて、図3(a)に示されているよう  
に、シリコン酸化膜37をハードマスクとして、シリ  
コン窒化膜36がエッチングされ、ハードマスクパター  
ン36aが形成される。

【0096】続いて、図3(b)に示されているよう  
に、シリコン酸化膜37とシリコン窒化膜36とをハ  
ードマスクとして、Silk<sup>T</sup>膜35がエッチングさ  
れ、BCB膜34に到達する開口35aが形成される。  
Silk<sup>T</sup>膜35は、N<sub>2</sub>ガスとH<sub>2</sub>ガスとの混合ガ  
スをエッチングガスとしてエッチングされる。この  
とき、BCB膜34は、N<sub>2</sub>/H<sub>2</sub>プラズマに対して耐エ  
ッチング性を示すため、BCB膜34の上面で、Si  
lk<sup>T</sup>膜35のエッチングは停止する。

【0097】更に、開口35aの底部にあるBCB膜3 40  
4がエッチングされ、ブラグ33に到達するコンタ  
クトが形成される。更に、スパッタ法によりTa/TaNバ  
リア膜(図示されない)と、めっきの電極として使用さ  
れる電極用銅薄膜(図示されない)とが形成される。

【0098】続いて、銅がめっきにより埋め込まれ、更  
にCMP法により不必要なTa/TaNバリア膜と銅薄  
膜とが除去されて、図3(c)に示されているように、  
銅配線39が形成される。

【0099】実施例1の半導体装置の製造方法では、比  
誘電率がシリコン窒化膜の約3分の1であるBCB膜が 50

エッチングストッパーとして使用され、形成された半導  
体装置の配線間容量が減少されている。

【0100】実施例2:図4、図5及び図6は、実施例  
2に係る半導体装置の製造方法を示す断面図である。実  
施例2では、一のシリコン含有有機膜をハードマスクと  
し、且つ、他のシリコン含有有機膜をエッチングスト  
ッパーとしてシリコン非含有有機膜に開口が形成される。

【0101】まず、図4(a)に示されているように、  
シリコン基板40の上面に、MOSTランジスタ41が  
形成される。より詳細には、シリコン基板40の上面  
に、MOSTランジスタ41を構成するソース/ドレ  
イン41a、ゲート41b、及びサイドウォール41cが  
形成される。

【0102】続いて、図4(b)に示されているよう  
に、層間絶縁膜として、シリコン酸化膜42がMOST  
ランジスタ41を覆うように形成される。更に、図4  
(c)に示されているように、MOSTランジスタ41  
のソース/ドレイン41bに接続するブラグ43が形成  
される。ブラグ43は、タングステンブラグのような導  
電性ブラグで形成される。

【0103】続いて、図5(a)に示されているよう  
に、シリコン酸化膜42とブラグ43とを被覆するよう  
に、第1BCB膜44が形成される。第1BCB膜44  
は、ジビニルシロキサンベンゾシクロブテン重合体  
により構成されるシリコン含有有機膜である。第1BCB  
膜44は、シリコン酸化膜よりも低い比誘電率を有し、  
その比誘電率は2.6である。

【0104】更に、第1BCB膜44の上面に、Si  
lk<sup>T</sup>膜45が形成される。Silk<sup>T</sup>膜45は、ス  
ピンオン塗付により形成される。後述されるように、  
Silk<sup>T</sup>膜45の下面にある第1BCB膜44は、Si  
lk<sup>T</sup>膜45をエッチングする際のエッチングスト  
ッパーになる。

【0105】更に、Silk<sup>T</sup>膜45の上面には、第  
2BCB膜46と、シリコン酸化膜47とが順次に形成  
される。第2BCB膜46は、ジビニルシロキサンベン  
ゾシクロブテン重合体により構成されるシリコン含有  
有機膜である。後述されるように、第2BCB膜46と、  
シリコン酸化膜47とは、Silk<sup>T</sup>膜45をエッチ  
ングする際のハードマスクとなる。

【0106】続いて、図5(b)に示されているよう  
に、第2BCB膜46の上面にフォトレジスト48が形  
成される。更に、フォトリソグラフィ技術を用いてフ  
ォトレジスト48に配線溝パターン48aが形成され  
る。

【0107】続いて、図5(c)に示されているよう  
に、フォトレジスト48をマスクとして、シリコン酸化  
膜47がエッチングされ、パターン47aが形成され  
る。更に、シリコン酸化膜47のエッチングの後、N<sub>2</sub>  
/H<sub>2</sub>プラズマによりフォトレジスト48が除去され



る。

【0108】第2BCB膜46は、 $N_2/H_2$  プラズマに対して耐エッチング性を有し、 $N_2/H_2$  プラズマを使用してエッチングされたときの第2BCB膜46のエッチング速度は低い。一方、フォトレジスト48は、 $N_2/H_2$  プラズマでアッシングされる際のアッシング速度が大きい。したがって、 $N_2/H_2$  プラズマによりフォトレジスト48を除去しても、第2BCB膜46は、エッチングされない。

【0109】続いて、図6(a)に示されているように、シリコン酸化膜47をマスクとして、第2BCB膜46が $N_2/O_2$  プラズマによりエッチングされ、パターン46aが形成される。

【0110】続いて、図6(b)に示されているように、パターン46aが形成された第2BCB膜46と、シリコン酸化膜47とをハードマスクとして、 $Silk^TM$  膜45が、 $N_2/H_2$  プラズマでエッチングされ、第1BCB膜44に到達する開口45aが形成される。このとき、 $N_2/H_2$  プラズマに対して耐エッチング性を示す第1BCB膜44の上面で、 $Silk^TM$  膜45 20のエッチングは停止する。

【0111】続いて、シリコン酸化膜47をハードマスクとして、第1BCB膜44が窒素ガスと酸素ガスの混合ガスをエッチングガスとしてエッチングされ、プラグ44に到達するコンタクトが形成される。このとき、エッチングガスに0.1~5mol%程度のフッ素系ガスが添加されることが好ましい。

【0112】更に、イオン化スパッタ法でTa/TaNバリア膜(図示されない)と電極用銅膜(図示されない)とが形成される。更に、形成された電極用銅膜を電極として、銅が、めっき法によりコンタクトに埋め込まれる。更に、CMP法により、不必要なTa/TaNバリア膜と銅膜とが除去されて、銅配線49が形成される。

【0113】実施例2の半導体装置の製造方法では、エッチングストッパーとハードマスクの両者が低誘電率のシリコン含有有機膜であるBCB膜により形成され、更なる配線間容量の低減が実現される。

【0114】実施例3:図7、図8、及び図9は、実施例3に係る半導体装置の製造方法を示す断面図である。実施例3は、一のシリコン含有有機膜をマスクとし、且つ、他のシリコン含有有機膜をエッチングストッパーとしてシリコン非含有有機膜に開口が形成される点で実施例2と共通するが、実施例3の製造方法の構成は、実施例2の構成とは異なる。

【0115】まず、図7(a)に示されているように、シリコン基板50の上面に、MOSTランジスタ51が形成される。より詳細には、シリコン基板50の上面に、MOSTランジスタ51を構成するソース/ドレイン51a、ゲート51b、及びサイドウォール51cが形成される。

【0116】続いて、図7(b)に示されているように、層間絶縁膜として、シリコン酸化膜52がMOSTランジスタ51を覆うように形成される。更に、図7(c)に示されているように、MOSTランジスタ51のソース/ドレイン51bに接続するプラグ53が形成される。プラグ53は、タングステンプラグのような導電性プラグで形成される。

【0117】続いて、図8(a)に示されているように、シリコン酸化膜52とプラグ53とを被覆するように、第1BCB膜54が形成される。第1BCB膜54は、ジビニルシロキサンベンゾシクロブテン重合体により構成されるシリコン含有有機膜である。第1BCB膜54は、シリコン酸化膜よりも低い比誘電率を有し、その比誘電率は2.6である。

【0118】更に、第1BCB膜54の上面に、 $Silk^TM$  膜55が形成される。 $Silk^TM$  膜55は、スピノン塗付により形成される。後述されるように、 $Silk^TM$  膜55の下面にある第1BCB膜54は、 $Silk^TM$  膜55をエッチングする際のエッチングストッパーになる。

【0119】更に、 $Silk^TM$  膜55の上面に、第2BCB膜56が形成される。第2BCB膜56は、第1BCB膜54と同様に、ジビニルシロキサンベンゾシクロブテン重合体により構成されるシリコン含有有機膜である。第2BCB膜56は、第1BCB54よりも厚く形成される。

【0120】続いて、図8(b)に示されているように、第2BCB膜56の上面にフォトレジスト57が形成される。更に、フォトリソグラフィ技術を用いてフォトレジスト57に開口溝57aが形成される。

【0121】続いて、図8(c)に示されているように、フォトレジスト57をマスクとして、 $N_2/O_2$  プラズマで第2BCB膜56がエッチングされる。

【0122】第2BCB膜56のエッチングが完了した後、図9(a)に示されているように、 $N_2/H_2$  プラズマによって $Silk^TM$  膜55のエッチングと、フォトレジスト57の除去とが同時に行われる。 $Silk^TM$  膜55には、開口55aが形成される。 $Silk^TM$  膜55とフォトレジスト57とはいずれもシリコン非含有有機膜であり、 $N_2/H_2$  プラズマによってエッチングされたときのエッチング速度は大きい。一方、第1BCB膜54と第2BCB膜56は、 $N_2/H_2$  プラズマによってエッチングされたときのエッチング速度は非常に小さい。フォトレジスト57の $N_2/H_2$  プラズマによるエッチングは第2BCB膜56の上面で停止し、且つ、 $Silk^TM$  膜55の $N_2/H_2$  プラズマによるエッチングは、第1BCB膜54の上面で停止する。したがって、フォトレジスト57の剥離を行いながら、同時に、 $Silk^TM$  膜55に開口55aを形成することが可能である。



に、Silk<sup>T</sup>膜72の上面に、低誘電率のシリコン含有有機膜であるBCB膜73が成膜される。更に、BCB膜73を覆うように、シリコン酸化膜74が成長される。後述されるように、シリコン酸化膜74は、BCB膜73をエッチングするときのハードマスクになる。

【0138】続いて、図12(b)に示されているように、シリコン酸化膜74の上面にフォトレジスト75が形成される。更に、フォトリソグラフィー技術を用いてフォトレジスト75に配線溝形成用レジストパターン75aが形成される。

【0139】続いて、図12(c)に示されているように、フォトレジスト75をマスクとして、フッ素系プラズマを用いてシリコン酸化膜74がエッチングされ、配線溝パターン74aが形成される。更に、N<sub>2</sub>/H<sub>2</sub>プラズマによりフォトレジスト75が剥離される。このとき、配線溝パターン74aの底部において、BCB膜73はN<sub>2</sub>/H<sub>2</sub>プラズマに曝される。しかし、N<sub>2</sub>/H<sub>2</sub>プラズマに対して耐エッチング性を有するBCB膜73は、エッチングされない。

【0140】続いて、図13(a)に示されているように、配線溝パターン74aが形成されたシリコン酸化膜74の上面に、フォトレジスト77が形成される。更に、フォトリソグラフィー技術を用いてフォトレジスト77にビア開口用レジストパターン76が形成される。

【0141】続いて、図13(b)に示されているように、銅配線39に到達するビア開口78aと配線溝78bとが形成される。より詳細には、以下のようにして、ビア開口78aと配線溝78bとが形成される。ビア開口用レジストパターン76が形成された後、まず、フォトレジスト77をマスクとして、N<sub>2</sub>/O<sub>2</sub>プラズマによってBCB膜73がエッチングされる。更に、エッチングガスが窒素ガスと水素ガスとの混合ガスに切り替えられ、N<sub>2</sub>/H<sub>2</sub>プラズマによってSilk<sup>T</sup>膜72がエッチングされ、銅配線39に到達するビア開口78aが形成される。

【0142】N<sub>2</sub>/H<sub>2</sub>プラズマによってSilk<sup>T</sup>膜72がエッチングされる際には、同時に、フォトレジスト75が剥離される。N<sub>2</sub>/H<sub>2</sub>プラズマによってSilk<sup>T</sup>膜72のエッチングとフォトレジスト75の剥離とが行われた後、シリコン酸化膜74をマスクとして、BCB膜78がエッチングされ、配線溝78bが形成される。

【0143】続いて、図13(c)に示されているように、ビア開口78aと配線溝78bとに一括して銅が埋め込まれ、銅配線79が形成される。

【0144】実施例5の半導体装置の製造方法では、シリコン窒化膜やシリコン酸化膜、炭化シリコン膜のような高い比誘電率を有するエッチングストッパーが使用されておらず、実施例4と同様に、配線間容量の大きな減少が実現される。

【0145】実施例6：図14と図15とは、実施例6に係る半導体装置の製造方法を示す断面図である。

【0146】まず、図14(a)に示されているように、シリコン基板30の上面に、下部配線構造81が形成される。下部配線構造81は、MOSトランジスタ31、シリコン酸化膜32、プラグ33、BCB膜34、Silk<sup>T</sup>膜35、シリコン窒化膜36、シリコン酸化膜37、銅配線39とを含み、その形成過程は、前述の実施例1に係る半導体装置の製造方法と同一である。

【0147】更に、下層配線構造81の上面に、キャップBCB膜82が形成される。キャップBCB膜82は、シリコン含有有機膜であるBCB膜により形成される。更に、キャップBCB膜82の上面に、Silk<sup>T</sup>膜83をスピン塗布法によって成膜する。更に、Silk<sup>T</sup>膜83の上面にBCB膜84が形成される。更に、BCB膜84の上面にSilk<sup>T</sup>膜85が形成される。後述されるように、Silk<sup>T</sup>膜85の下面にあるBCB膜84は、Silk<sup>T</sup>膜85をエッチングする際のエッチングストッパーになる。更に、Silk<sup>T</sup>膜85の上面には、BCB膜86とシリコン酸化膜87とが、順次に成膜される。後述されるように、BCB膜86とシリコン酸化膜87とは、Silk<sup>T</sup>膜85をエッチングする際のデュアルハードマスクになる。

【0148】続いて、図14(b)に示されているように、シリコン酸化膜87の上面にフォトレジスト88が形成される。更に、フォトリソグラフィー技術を用いてフォトレジスト88に配線溝形成用レジストパターン88aが形成される。

【0149】続いて、図14(c)に示されているように、フォトレジスト88をマスクとして、フッ素系プラズマを用いてシリコン酸化膜87がエッチングされ、配線溝パターン87aが形成される。更に、N<sub>2</sub>/H<sub>2</sub>プラズマによりフォトレジスト88が剥離される。このとき、配線溝パターン87aの底部において、BCB膜86はN<sub>2</sub>/H<sub>2</sub>プラズマに曝される。しかし、N<sub>2</sub>/H<sub>2</sub>プラズマに対して耐エッチング性を有するBCB膜86は、エッチングされない。したがって、BCB膜86の下面にあるSilk<sup>T</sup>膜85もエッチングされない。

【0150】続いて、図15(a)に示されているように、シリコン酸化膜87の上面に、フォトレジスト90が形成される。更に、フォトリソグラフィー技術を用いてフォトレジスト90にビア開口用レジストパターン89が形成される。

【0151】続いて、図15(b)に示されているように、銅配線39に到達するビア開口91aと配線溝91bとが形成される。より詳細には、以下のようにしてビア開口91aと配線溝91bとが形成される。ビア開口用レジストパターン89が形成された後、まず、フォ

レジスト90をマスクとして、 $N_2/O_2$  プラズマにより、BCB膜86と、 $SiI k^T M$  膜85と、BCB膜84とが、順次にエッチングされる。この時のエッチングは、フォトレジスト88がBCB膜84のエッチングが完了した時点では除去されているような条件で行われる。更に、 $N_2/H_2$  プラズマにより、 $SiI k^T M$  膜83のエッチングが行われる。 $SiI k^T M$  膜83のエッチングは、BCB膜で形成されたキャップ膜BCB82の上面で停止する。かかる一連のエッチングにより、BCB膜86、 $SiI k^T M$  膜85、BCB膜84、及び $SiI k^T M$  膜83を貫き、且つ、キャップBCB膜82に到達する開口が形成される。

【0152】続いて、エッチングガスが窒素ガスと酸素ガスの混合ガスに切り替えられる。これにより、前述の開口の底部にあるキャップBCB膜82が除去され、ビア開口91aが形成される。このとき、同時に、シリコン酸化膜87に形成された配線溝パターン87aの下にあるBCB膜86が除去される。続いて、エッチングガスが、再び窒素ガスと水素ガスの混合ガスに切り替えられ、 $SiI k^T M$  膜85に配線溝91bが形成される。

【0153】その後、図15(c)に示されているように、ビア開口91aと配線溝91bとに一括して銅が埋め込まれ、銅配線92が形成される。

【0154】実施例6の半導体装置の製造方法は、実施例4及び実施例5の半導体装置の製造方法と同様に、配線間容量の大きな減少を実現する。

【0155】実施例7：図16と図17とは、実施例7に係る半導体装置の製造方法を示す断面図である。

【0156】まず、図16(a)に示されているように、シリコン基板30の上面に、下部配線構造101が形成される。下部配線構造101は、MOSTランジスタ31、シリコン酸化膜32、プラグ33、BCB膜34、 $SiI k^T M$  膜35、シリコン窒化膜36、シリコン酸化膜37、銅配線39を含み、その形成過程は、前述の実施例1に係る半導体装置の製造方法と同一である。

【0157】更に、下層配線構造101の上面に、キャップ膜として、25nm程度の薄いシリコン窒化膜102が成膜される。シリコン窒化膜102が薄くされていることにより、実効的な比誘電率の上昇が抑制されている。シリコン窒化膜102の上面には、BCB膜103が成膜される。更に、BCB膜103の上面に、20nm程度のシリコン窒化膜104が成膜される。更に、シリコン窒化膜104の上面に、BCB膜105が成膜される。BCB膜105の下面にあるシリコン窒化膜104は、BCB膜105をエッチングする際のエッチングストッパーになる。

【0158】BCB膜105の上面には、更に、シリコン酸化膜106が成膜される。シリコン酸化膜106は、BCB膜105をエッチングする際のハードマスク

になる。更に、シリコン酸化膜106の上面には、反射防止膜107が塗布により形成される。

【0159】反射防止膜107の上面には、フォトレジスト108が形成される。更に、フォトリソグラフィ技術により、フォトレジスト108に、ビア開口用レジストパターン108aが形成される。

【0160】続いて、図16(b)に示されているように、フォトレジスト108をマスクとして、窒素ガスと酸素ガスとフッ素系ガスの混合ガスをエッチングガスとして反射防止膜107、シリコン酸化膜106、BCB膜105、シリコン窒化膜104、及びBCB膜103が、順次エッチングされ、ビア開口パターン103aが形成される。このときのエッチングは、シリコン窒化膜102に到達すると停止する。更に、 $N_2/H_2$  プラズマによりフォトレジスト108と反射防止膜107とが剥離される。このとき、BCB膜103、BCB膜105、シリコン窒化膜102、シリコン窒化膜104は、いずれも、 $N_2/H_2$  プラズマによりエッチングされないため、ビア開口パターン103aの寸法シフトは発生しにくい。

【0161】続いて、図16(c)に示されているように、反射防止膜109が塗布される。このとき、ビア開口パターン103aの内部に、塗付された反射防止膜109が多量に埋まる。続いて、フォトレジスト110が、反射防止膜109の上面に成膜される。成膜されたフォトレジスト110に、配線溝形成用レジストパターン110aがフォトリソグラフィ技術により形成される。

【0162】続いて、図17(a)に示されているように、フォトレジスト110をマスクとし、窒素ガスと酸素ガスとフッ素系ガスの混合ガスをエッチングガスとして、反射防止膜109、BCB膜105が順次にエッチングされ、配線溝105aが形成される。このとき、BCB膜105のエッチングは、シリコン窒化膜104で自動的に停止する。

【0163】その後、図17(b)に示されているように、残存している反射防止膜109とフォトレジスト108とが、 $N_2/H_2$  プラズマによりアッシングされる。このとき、BCB膜103とBCB膜105とは、 $N_2/H_2$  プラズマによりエッチングされない。したがって、反射防止膜109とフォトレジスト108とのアッシングの際には、十分なオーバーエッチングを行うことが可能である。反射防止膜109とフォトレジスト108とが、十分に $N_2/H_2$  プラズマによりアッシングされ、前述のビア開口パターン103aが、再度、開口される。

【0164】その後、ビア開口パターン103aの底部にあるシリコン窒化膜102と、配線溝105aの底部にあるシリコン窒化膜104がエッチバックにより除去される。その後、イオン化スバッタ法で100nm厚程

度の銅シード膜が成長され、更に、MOCVD法により銅膜が成長され、配線溝105aとビア開口パターン103aとに銅膜が埋め込まれる。このとき、Ta/TaNバリア膜は成長されない。これは、BCB膜自体に銅の拡散を防ぐバリア性があるためである。その後、350℃から400℃でアニールが行われる。すると、銅膜のうち、ビア開口パターン103aの内部にある銅膜は、下部配線構造101の銅配線39の結晶方位を引き継いでエビ成長する。ビア開口パターン103aの内部の銅膜は、銅配線39と結合され、概ね、単結晶化される。このようにして形成された単結晶化銅ビアは、抵抗が通常のビア抵抗に対して50%程度以上も低く、エレクトロマイグレーション耐性は、10倍以上高い。

【0165】以上に説明された実施例7の半導体装置の製造方法は、ビア開口パターン103aに厚く埋まった反射防止膜109を十分にアッシングすることが可能である。この実施例7の半導体装置の製造方法は、ビアを配線溝よりも先行して形成する半導体装置の製造プロセスにおいて、配線の微細化のために反射防止膜を用いる場合に、特に有効である。

【0166】

【発明の効果】本発明により、複数の有機膜を高い選択比でエッチングする技術が提供される。

【0167】また、本発明により、配線間容量が削減された半導体装置の製造が可能になる。

【0168】また、本発明により、半導体装置の製造工程の自由度が高められる。

【図面の簡単な説明】

【図1】図1は、本発明の一実施の形態の実施例1による半導体装置の製造方法を示す。

【図2】図2は、本発明の一実施の形態の実施例1による半導体装置の製造方法を示す。

【図3】図3は、本発明の一実施の形態の実施例1による半導体装置の製造方法を示す。

【図4】図4は、本発明の一実施の形態の実施例2による半導体装置の製造方法を示す。

【図5】図5は、本発明の一実施の形態の実施例2による半導体装置の製造方法を示す。

【図6】図6は、本発明の一実施の形態の実施例2による半導体装置の製造方法を示す。

【図7】図7は、本発明の一実施の形態の実施例3による半導体装置の製造方法を示す。

【図8】図8は、本発明の一実施の形態の実施例3による半導体装置の製造方法を示す。

【図9】図9は、本発明の一実施の形態の実施例3による半導体装置の製造方法を示す。

【図10】図10は、本発明の一実施の形態の実施例4による半導体装置の製造方法を示す。

【図11】図11は、本発明の一実施の形態の実施例4による半導体装置の製造方法を示す。

【図12】図12は、本発明の一実施の形態の実施例5による半導体装置の製造方法を示す。

【図13】図13は、本発明の一実施の形態の実施例5による半導体装置の製造方法を示す。

【図14】図14は、本発明の一実施の形態の実施例6による半導体装置の製造方法を示す。

【図15】図15は、本発明の一実施の形態の実施例6による半導体装置の製造方法を示す。

【図16】図16は、本発明の一実施の形態の実施例7による半導体装置の製造方法を示す。

【図17】図17は、本発明の一実施の形態の実施例7による半導体装置の製造方法を示す。

【図18】図18は、ジビニルシロキサンベンゾシクロブテン重合体で形成されたBCB膜を形成する装置を示す。

【図19】図19は、従来の半導体装置の製造方法を示す。

【図20】図20は、従来の半導体装置の製造方法を示す。

【図21】図21は、従来の半導体装置の製造方法を示す。

【図22】図22は、従来の他の半導体装置の製造方法を示す。

【図23】図23は、従来の他の半導体装置の製造方法を示す。

【図24】図24は、従来の他の半導体装置の製造方法を示す。

【図25】図25は、従来の他の半導体装置の製造方法を示す。

【符号の説明】

30：シリコン基板

31：MOSトランジスタ

32：シリコン酸化膜

33：プラグ

34：BCB膜

35：Silk<sup>TM</sup>膜

36：シリコン窒化膜

37：シリコン酸化膜

38：フォトレジスト

39：銅配線

40：シリコン基板

41：MOSトランジスタ

42：シリコン酸化膜

43：プラグ

44：BCB膜

45：Silk<sup>TM</sup>膜

46：BCB膜

47：シリコン窒化膜

48：フォトレジスト

49：銅配線

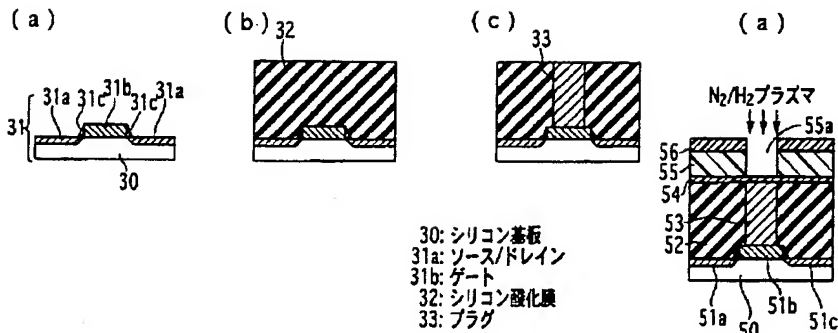
50: シリコン基板  
 51: MOSTランジスタ  
 52: シリコン酸化膜  
 53: プラグ  
 54: BCB膜  
 55: Silk™膜  
 56: BCB膜  
 57: フォトリソ  
 58: 銅配線  
 61: 下部配線構造  
 62: BCB膜  
 63: Silk™膜  
 64: BCB膜  
 65: シリコン酸化膜  
 66: フォトリソ  
 67: フォトリソ  
 70: 銅配線  
 71: 下部配線構造  
 72: Silk™膜  
 73: BCB膜  
 74: シリコン酸化膜  
 75: フォトリソ  
 77: フォトリソ

\* 79: 銅配線  
 81: 下部配線構造  
 82: キャップBCB膜  
 83: Silk™膜  
 84: BCB膜  
 85: Silk™膜  
 86: BCB膜  
 87: シリコン酸化膜  
 88: フォトリソ  
 90: フォトリソ  
 92: 銅配線  
 101: 下部配線構造  
 102: シリコン窒化膜  
 103: BCB膜  
 104: シリコン窒化膜  
 105: BCB膜  
 106: シリコン酸化膜  
 107: 反射防止膜  
 108: フォトリソ  
 109: 反射防止膜  
 110: フォトリソ  
 111: 銅配線

\*

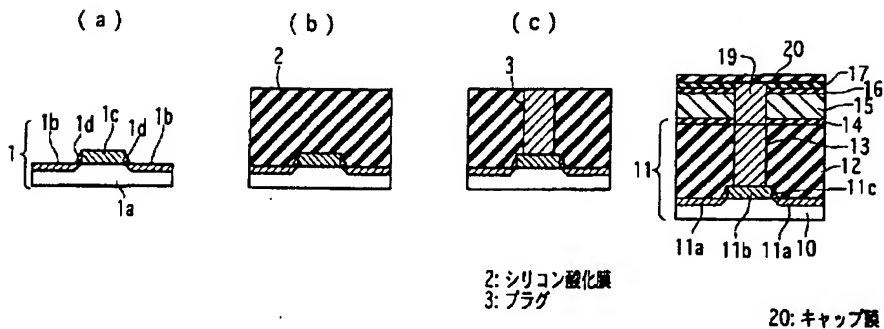
【図1】

【図9】

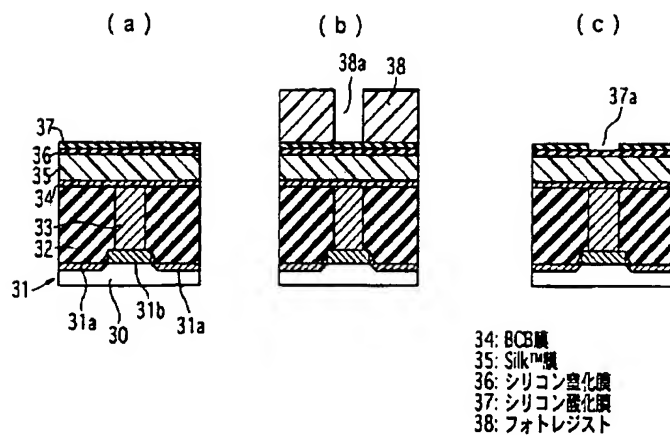


【図19】

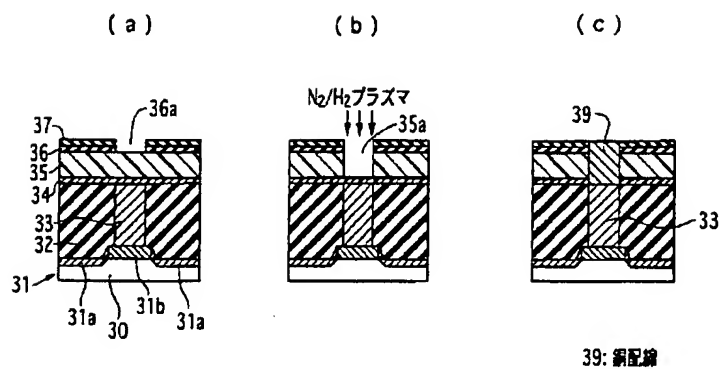
【図25】



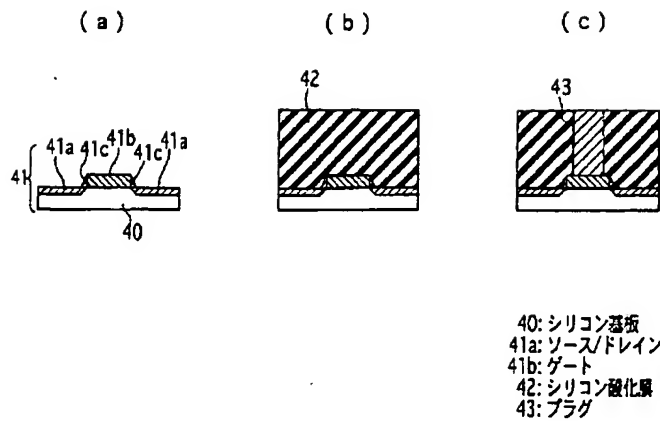
【図2】



【図3】

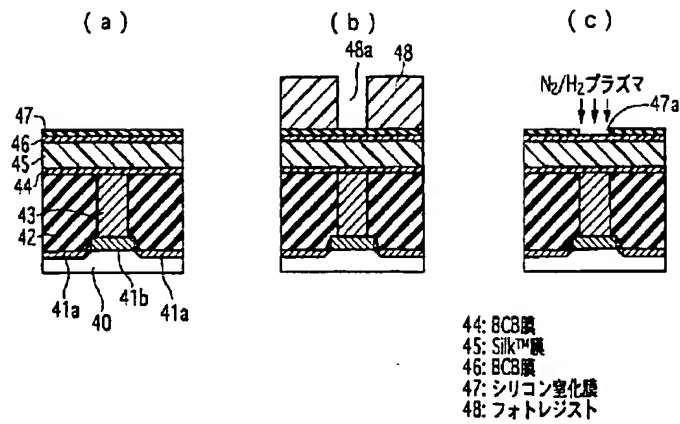


【図4】

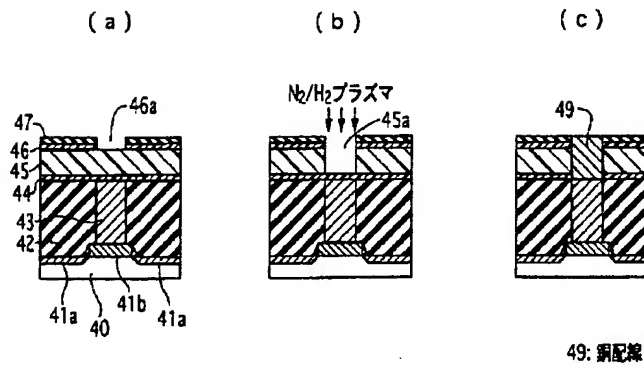




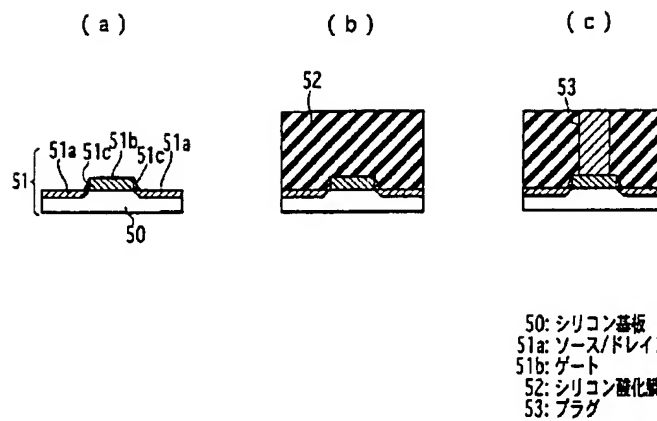
【図5】



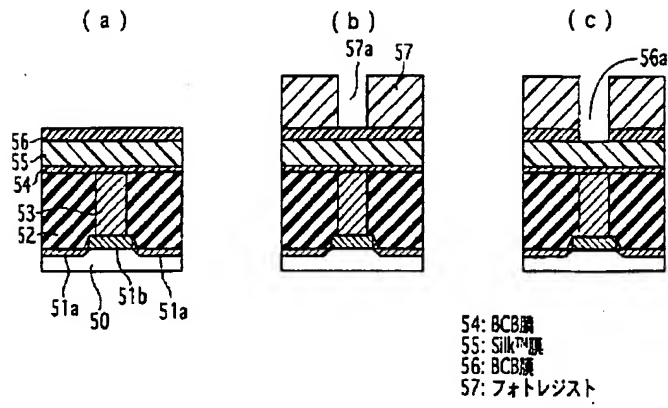
【図6】



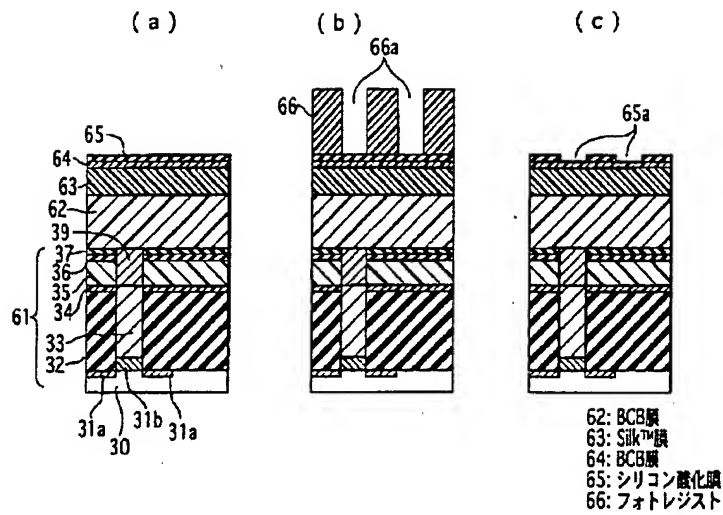
【図7】



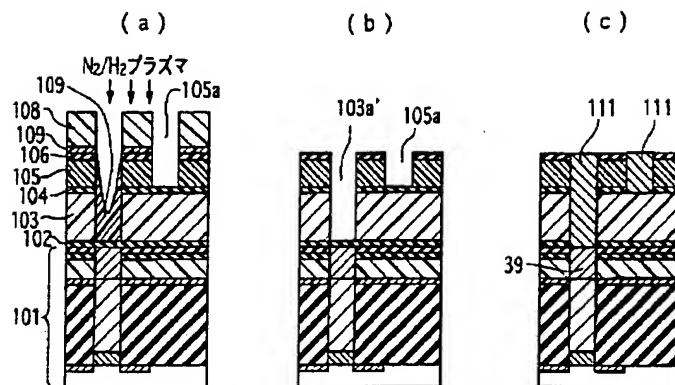
【図 8】



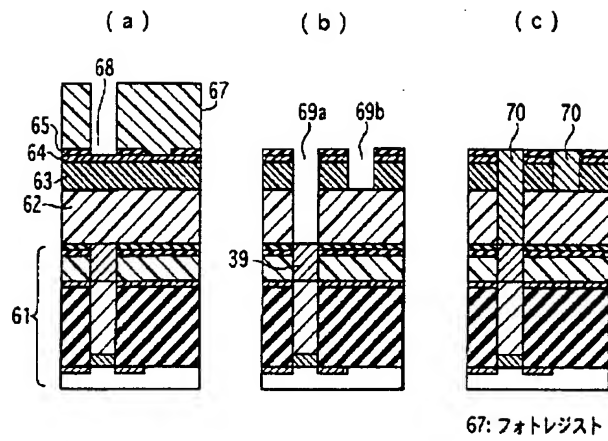
【図 10】



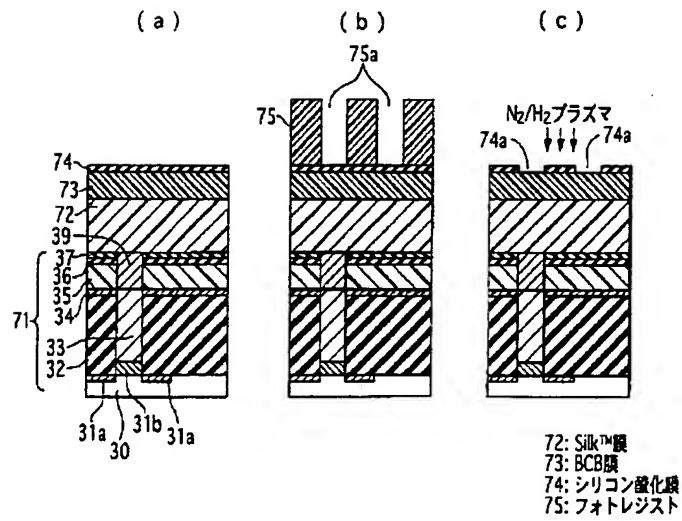
【図 17】



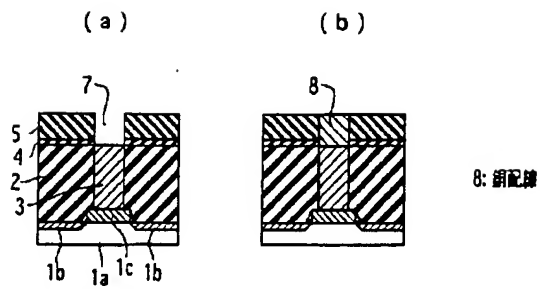
【図11】



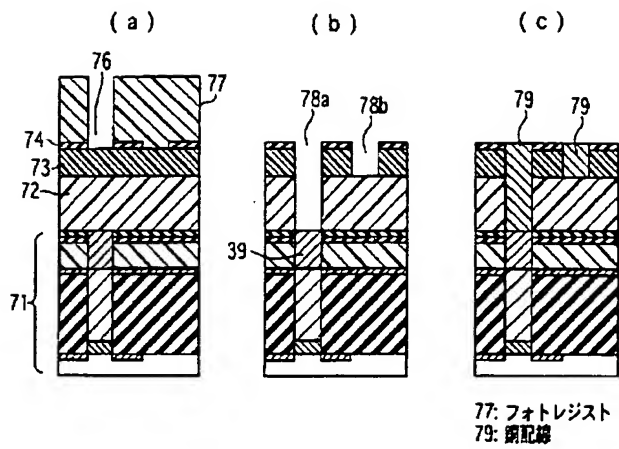
【図12】



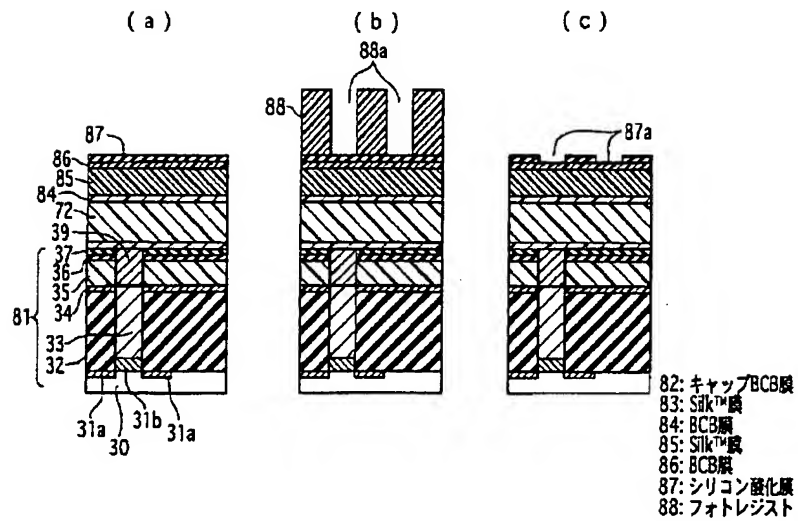
【図21】



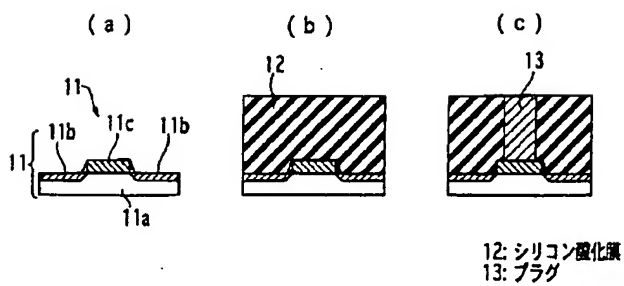
【図13】



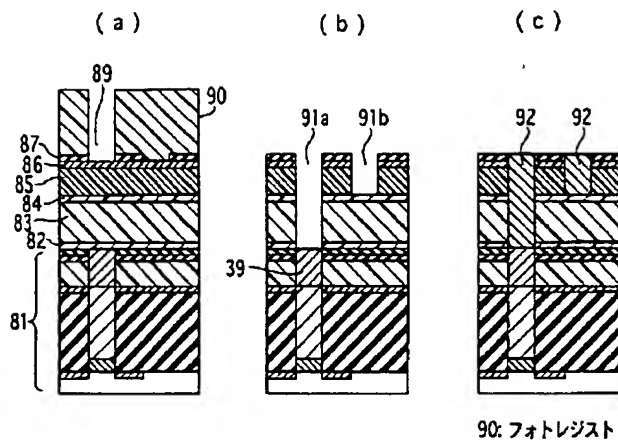
【図14】



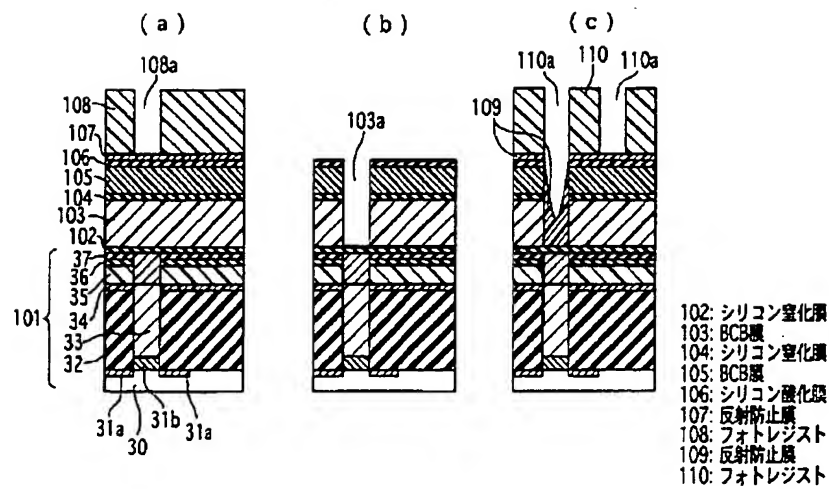
【図22】



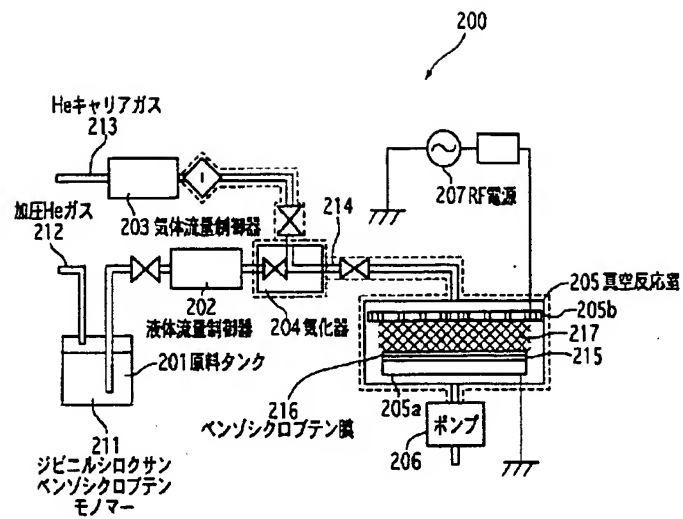
【図15】



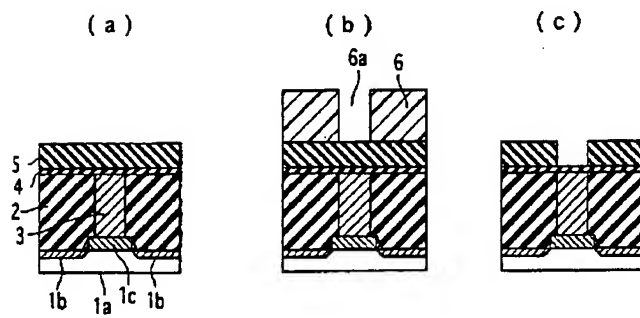
【図16】



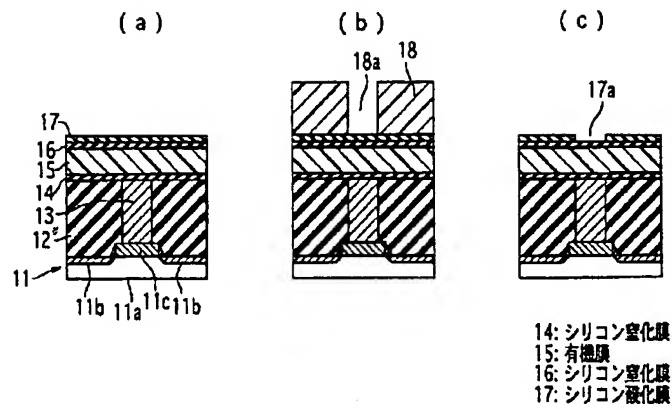
【図18】



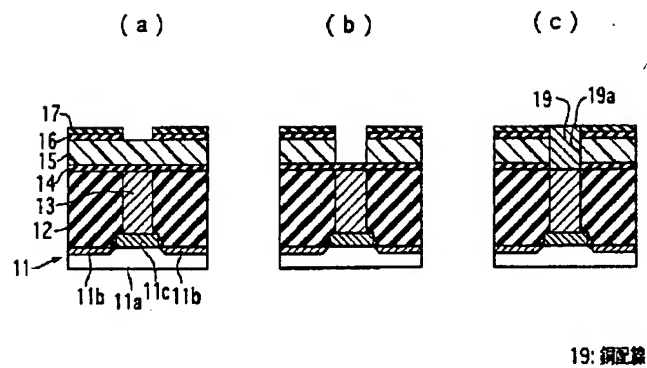
【図20】



【図23】



【図24】



フロントページの続き

(51)Int.Cl.

識別記号

F I  
H 0 1 L 21/90

テーマコード (参考)

P  
S

(72)発明者 多田 宗弘  
東京都港区芝五丁目7番1号 日本電気株  
式会社内

(72)発明者 林 喜宏  
東京都港区芝五丁目7番1号 日本電気株  
式会社内



F ターム(参考) SF004 AA05 BA04 CA02 CA03 DA24  
DA25 DA26 DB03 DB23 EB03  
SF033 HH11 HH21 HH32 JJ11 JJ19  
JJ21 JJ32 KK11 KK21 KK32  
MM01 MM12 MM13 NN06 NN07  
PP11 PP15 PP27 QQ04 QQ09  
QQ11 QQ12 QQ15 QQ21 QQ25  
QQ28 QQ31 QQ35 QQ48 QQ96  
RR04 RR06 RR22 RR23 RR24  
SS21 SS22 TT03 TT04 XX01  
XX03 XX05 XX09 XX10 XX24  
SF045 AA06 AA08 AB32 AB39 AC17  
AF03 BB16 CB05 DC63 EE02  
EF05  
SF058 AA10 AD01 AD05 AD09 AF04  
AH02